オペアンプシリーズ

車載向け 高 EMI 耐量 グランドセンスオペアンプ

BA82904Yxxx-C　BA82902Yxxx-C

概要

BA82904Yxxx-C、BA82902Yxxx-C は、高利得かつグランドセンス入力の独立したオペアンプを 1 チップに 2 回路または 4 回路集積したモノリシック IC です。
特に動作範囲が 3V～36V (単一電源動作の場合) と広く、消費電流が少なくエンジンコントロールユニット、EPS、ABS などの車載用途全般に使用可能です。
さらに、EMI 耐量のアドバンテージを持ち、現状品からの置き換えや EMI 設計も容易です。

特長

- AEC-Q100 対応*(Note1)*
- 単一電源動作可能
- 動作電源電圧範囲が広い
- 標準のオペアンプ端子配置
- 入力、出力ともに、ほぼ GND レベルより動作可能
- 消費電源電流が少ない
- 直流電圧利得が大きい
- 静電気保護回路内蔵
- 動作温度範囲が広い
- EMI フィルタ内蔵

(Note1) Grade 1

用途

- エンジンコントロールユニット
- EPS
- ABS
- 車載電装品全般

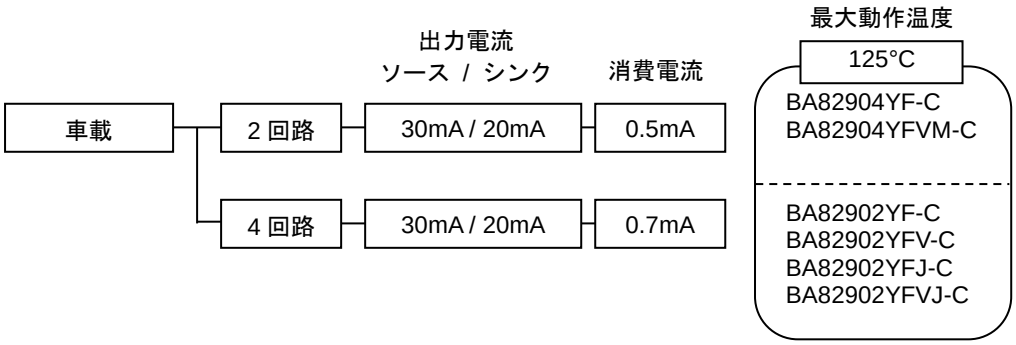
重要特性

- 動作電源電圧範囲
  - 単電源: 3V～36V
  - 両電源: ±1.5V～±18.0V
- 低消費電源電流
  - BA82904Yxxx-C 0.5mA (Typ)
  - BA82902Yxxx-C 0.7mA (Typ)
- 入力バイアス電流: 20nA (Typ)
- 入力オフセット電流: 2nA (Typ)
- 動作温度範囲: -40°C～+125°C

パッケージ

パッケージ	W(Typ) x D(Typ) x H(Max)
SOP8	5.00mm x 6.20mm x 1.71mm
SOP14	8.70mm x 6.20mm x 1.71mm
SSOP-B14	5.00mm x 6.40mm x 1.35mm
MSOP8	2.90mm x 4.00mm x 0.90mm
SOP-J14	8.65mm x 6.00mm x 1.65mm
TSSOP-B14J	5.00mm x 6.40mm x 1.20mm

セレクションガイド



○製品構造：シリコンモノリシック集積回路　○耐放射線設計はしておりません

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

等価回路図

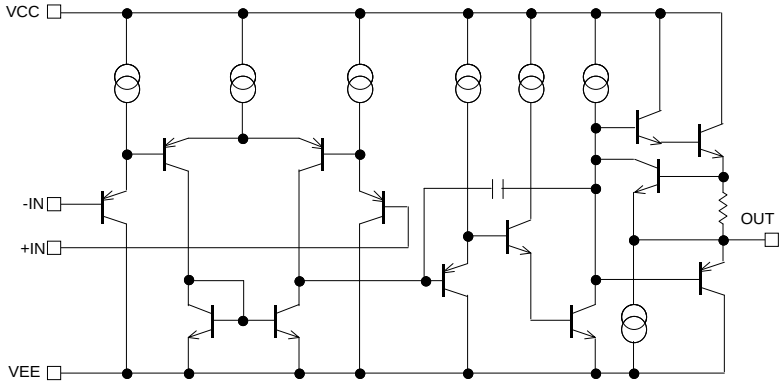
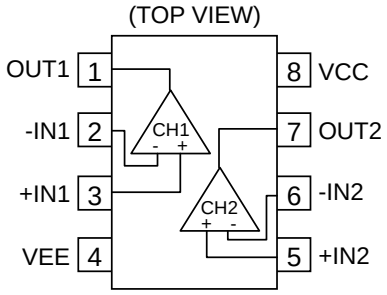


Figure 1. 内部等価回路図 (1 回路のみ)

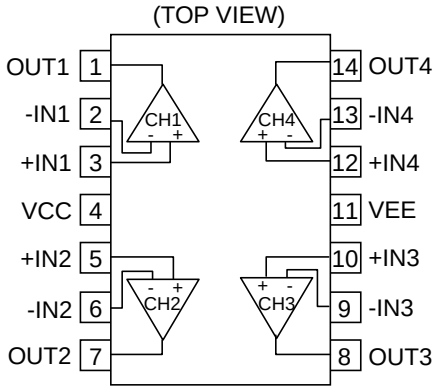
端子配置図

BA82904YF-C: SOP8
BA82904YFVM-C: MSOP8



端子番号	端子名
1	OUT1
2	-IN1
3	+IN1
4	VEE
5	+IN2
6	-IN2
7	OUT2
8	VCC

BA82902YF-C: SOP14
BA82902YFV-C: SSOP-B14
BA82902YFJ-C: SOP-J14
BA82902YFVJ-C: TSSOP-B14J



端子番号	端子名
1	OUT1
2	-IN1
3	+IN1
4	VCC
5	+IN2
6	-IN2
7	OUT2
8	OUT3
9	-IN3
10	+IN3
11	VEE
12	+IN4
13	-IN4
14	OUT4

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

絶対最大定格 (Ta = 25°C)

項目	記号	定格	単位
電源電圧	V_{CC}-V_{EE}	36	V
差動入力電圧(Note 1)	V_{ID}	36	V
同相入力電圧範囲	V_{ICM}	(V_{EE}-0.3)～(V_{EE}+36)	V
入力電流	I_I	-10	mA
保存温度範囲	Tstg	-55～+150	°C
最高接合部温度	Tjmax	150	°C

注意１：印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を超えた場合は、劣化または破壊に至る可能性があります。また、ショートモードもしくはオープンモードなど、破壊状態を想定できません。絶対最大定格を超えるような特殊モードが想定される場合、ヒューズなど物理的な安全対策を施して頂けるようご検討お願いします。

注意２：最高接合部温度を超えるようなご使用をされますと、チップ温度上昇により、IC 本来の性質を悪化させることにつながります。最高接合部温度を超える場合は基板サイズを大きくする、放熱用銅箔面積を大きくする、放熱板を使用するなど、最高接合部温度を超えないよう熱抵抗にご配慮ください。

(Note 1) 差動入力電圧は反転入力端子と非反転入力端子間の電位差を示します。その時各入力端子の電位は V_{EE} 以上の電位としてください。

推奨動作条件

項目	記号	最小	標準	最大	単位
動作電源電圧	Vopr	3 (±1.5)	5 (±2.5)	36 (±18)	V
動作温度	Topr	-40	+25	+125	°C

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

熱抵抗(Note 1)

項目	記号	熱抵抗(Typ)		単位
		1 層基板(Note 3)	4 層基板(Note 4)	
MSOP8				
ジャンクション—周囲温度間熱抵抗	θ_{JA}	284.1	135.4	°C/W
ジャンクション—パッケージ上面中心間熱特性パラメータ(Note 2)	Ψ_{JT}	21	11	°C/W
SOP8				
ジャンクション—周囲温度間熱抵抗	θ_{JA}	197.4	109.8	°C/W
ジャンクション—パッケージ上面中心間熱特性パラメータ(Note 2)	Ψ_{JT}	21	19	°C/W
SOP14				
ジャンクション—周囲温度間熱抵抗	θ_{JA}	166.5	108.1	°C/W
ジャンクション—パッケージ上面中心間熱特性パラメータ(Note 2)	Ψ_{JT}	26	22	°C/W
SSOP-B14				
ジャンクション—周囲温度間熱抵抗	θ_{JA}	159.6	92.8	°C/W
ジャンクション—パッケージ上面中心間熱特性パラメータ(Note 2)	Ψ_{JT}	13	9	°C/W
SOP-J14				
ジャンクション—周囲温度間熱抵抗	θ_{JA}	118.5	67.2	°C/W
ジャンクション—パッケージ上面中心間熱特性パラメータ(Note 2)	Ψ_{JT}	10	10	°C/W
TSSOP-B14J				
ジャンクション—周囲温度間熱抵抗	θ_{JA}	185.4	98.4	°C/W
ジャンクション—パッケージ上面中心間熱特性パラメータ(Note 2)	Ψ_{JT}	16	14	°C/W

(Note 1) JESD51-2A(Still-Air) に準拠。
(Note 2) ジャンクションからパッケージ（モールド部分）上面中心までの熱特性パラメータ。
(Note 3) JESD51-3 に準拠した基板を使用。
(Note 4) JESD51-7 に準拠した基板を使用。

測定基板	基板材	基板寸法
1 層	FR-4	114.3mm x 76.2mm x 1.57mmt

1 層目（表面）銅箔	
銅箔パターン	銅箔厚
実装ランドパターン ＋電極引出し用配線	70μm

測定基板	基板材	基板寸法
4 層	FR-4	114.3mm x 76.2mm x 1.6mmt

1 層目（表面）銅箔		2 層目、3 層目（内層）銅箔		4 層目（裏面）銅箔	
銅箔パターン	銅箔厚	銅箔パターン	銅箔厚	銅箔パターン	銅箔厚
実装ランドパターン ＋電極引出し用配線	70μm	74.2mm□（正方形）	35μm	74.2mm□（正方形）	70μm

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

電気的特性

○BA82904Yxxx-C (特に指定のない限り V_{CC}=5V, V_{EE}=0V)

項目	記号	温度範囲	規格値			単位	条件
			最小	標準	最大		
入力オフセット電圧(Note 1)	V_{IO}	25°C	-	2	6	mV	V_{OUT}=1.4V
		全温度範囲	-	-	9		V_{CC}=5V～30V, V_{OUT}=1.4V
入力オフセット電流(Note 1)	I_{IO}	25°C	-	2	40	nA	V_{OUT}=1.4V
		全温度範囲	-	-	50		
入力バイアス電流(Note 1)	I_B	25°C	-	20	60	nA	V_{OUT}=1.4V
		全温度範囲	-	-	100		
回路電流	I_{CC}	25°C	-	0.5	1.2	mA	R_L=∞, All Op-Amps
		全温度範囲	-	-	1.2		
最大出力電圧(High)	V_{OH}	25°C	3.5	-	-	V	R_L=2kΩ
		全温度範囲	3.2	-	-		
			27	28	-		V_{CC}=30V, R_L=10kΩ
最大出力電圧(Low)	V_{OL}	全温度範囲	-	5	20	mV	R_L=∞, All Op-Amps
大振幅電圧利得	A_V	25°C	25	100	-	V/mV	R_L≥2kΩ, V_{CC}=15V V_{OUT}=1.4V～11.4V
		全温度範囲	25	-	-		
同相入力電圧範囲	V_{ICM}	25°C	0	-	V_{CC}-1.5	V	(V_{CC}-V_{EE})=5V V_{OUT}=V_{EE}+1.4V
		全温度範囲	0	-	V_{CC}-2.0		
同相信号除去比	CMRR	全温度範囲	70	80	-	dB	V_{OUT}=1.4V
電源電圧除去比	PSRR	全温度範囲	70	100	-	dB	V_{CC}=5V～30V
出力ソース電流(Note 2)	I_{SOURCE}	25°C	20	30	-	mA	V_{+IN}=1V, V_{-IN}=0V V_{OUT}=0V, 1CH のみ短絡
		全温度範囲	10	-	-		
出力シンク電流(Note 2)	I_{SINK}	25°C	10	20	-	mA	V_{+IN}=0V, V_{-IN}=1V V_{OUT}=5V, 1CH のみ短絡
		全温度範囲	2	-	-		
		25°C	12	40	-	μA	V_{+IN}=0V, V_{-IN}=1V V_{OUT}=200mV
スルーレート	SR	25°C	-	0.2	-	V/μs	V_{CC}=15V, A_V=0dB R_L=2kΩ, C_L=100pF
利得帯域幅積	GBW	25°C	-	0.5	-	MHz	V_{CC}=30V, R_L=2kΩ C_L=100pF
チャンネルセパレーション	CS	25°C	-	120	-	dB	f=1kHz，入力換算

(Note 1) 絶対値表記
(Note 2) 高温環境下では IC の Tjmax、熱抵抗を考慮し、出力電流値を決定してください。
出力端子を連続的に短絡すると、発熱による IC 内部の温度上昇のため出力電流値が減少する場合があります。

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

電気的特性 – 続き

○BA82902Yxxx-C (特に指定のない限り V_{CC}=5V, V_{EE}=0V)

項目	記号	温度範囲	規格値			単位	条件
			最小	標準	最大		
入力オフセット電圧(Note 1)	V_{IO}	25°C	-	2	6	mV	V_{OUT}=1.4V
		全温度範囲	-	-	9		V_{CC}=5V～30V, V_{OUT}=1.4V
入力オフセット電流(Note 1)	I_{IO}	25°C	-	2	40	nA	V_{OUT}=1.4V
		全温度範囲	-	-	50		
入力バイアス電流(Note 1)	I_B	25°C	-	20	60	nA	V_{OUT}=1.4V
		全温度範囲	-	-	100		
回路電流	I_{CC}	25°C	-	0.7	2	mA	R_L=∞, All Op-Amps
		全温度範囲	-	-	3		
最大出力電圧(High)	V_{OH}	25°C	3.5	-	-	V	R_L=2kΩ
		全温度範囲	3.2	-	-		
			27	28	-		V_{CC}=30V, R_L=10kΩ
最大出力電圧(Low)	V_{OL}	全温度範囲	-	5	20	mV	R_L=∞, All Op-Amps
大振幅電圧利得	A_V	25°C	25	100	-	V/mV	R_L≥2kΩ, V_{CC}=15V V_{OUT}=1.4V～11.4V
		全温度範囲	25	-	-		
同相入力電圧範囲	V_{ICM}	25°C	0	-	V_{CC}-1.5	V	(V_{CC}-V_{EE})=5V V_{OUT}=V_{EE}+1.4V
		全温度範囲	0	-	V_{CC}-2.0		
同相信号除去比	CMRR	全温度範囲	70	80	-	dB	V_{OUT}=1.4V
電源電圧除去比	PSRR	全温度範囲	70	100	-	dB	V_{CC}=5V～30V
出力ソース電流(Note 2)	I_{SOURCE}	25°C	20	30	-	mA	V_{+IN}=1V, V_{-IN}=0V V_{OUT}=0V, 1CH のみ短絡
		全温度範囲	10	-	-		
出力シンク電流(Note 2)	I_{SINK}	25°C	10	20	-	mA	V_{+IN}=0V, V_{-IN}=1V V_{OUT}=5V, 1CH のみ短絡
		全温度範囲	2	-	-		
		25°C	12	40	-	μA	V_{+IN}=0V, V_{-IN}=1V V_{OUT}=200mV
スルーレート	SR	25°C	-	0.2	-	V/μs	V_{CC}=15V, A_V=0dB R_L=2kΩ, C_L=100pF
利得帯域幅積	GBW	25°C	-	0.5	-	MHz	V_{CC}=30V, R_L=2kΩ C_L=100pF
チャンネルセパレーション	CS	25°C	-	120	-	dB	f=1kHz，入力換算

(Note 1) 絶対値表記
(Note 2) 高温環境下では IC の Tjmax、熱抵抗を考慮し、出力電流値を決定してください。
出力端子を連続的に短絡すると、発熱による IC 内部の温度上昇のため出力電流値が減少する場合があります。

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

電気的特性用語説明

ここでは本データシートに用いられる電気的特性用語の説明を記述します。項目と使用される記号も示します。
ここに挙げる項目名や記号、意味については他メーカーや一般の文書などとは異なる場合がありますのでご注意ください。

1. 絶対最大定格

絶対最大定格項目は瞬間的であっても超えてはならない条件を示すものです。絶対最大定格を超えた電圧の印加や絶対最大定格温度環境外での使用は、IC の特性劣化や破壊を生じる原因となります。

1.1 電源電圧 (V_{CC}-V_{EE})
正側電源端子と負側電源端子との間に内部回路の特性劣化や破壊なしに印加できる最大電圧を示します。

1.2 差動入力電圧 (V_{ID})
+入力端子と-入力端子の間に IC の特性劣化や破壊なしに印加できる最大電圧を示します。

1.3 同相入力電圧範囲 (V_{ICM})
+入力端子と-入力端子に IC の特性劣化や破壊なしに印加できる電圧範囲を示します。
最大定格の同相入力電圧範囲は IC の正常動作を保証するものではありません。IC の正常動作を期待する場合は電気的特性項目の同相入力電圧範囲に従う必要があります。

1.4 保存温度範囲 (Tstg)
保存温度範囲は IC の過度の特性劣化を生じずに保存できる温度範囲を示します。

2. 電気的特性項目

2.1 入力オフセット電圧 (V_{IO})
+入力端子と-入力端子との間の電位差を示します。出力電圧を 0V にするために必要な入力電圧差とも言い換えることができます。

2.2 入力オフセット電流 (I_{IO})
+入力端子と-入力端子の入力バイアス電流の差を示します。

2.3 入力バイアス電流 (I_B)
入力端子に流れ込むあるいは入力端子から流れ出す電流を示します。
+入力端子の入力バイアス電流と-入力端子の入力バイアス電流との平均値で定義します。

2.4 回路電流 (I_{CC})
無負荷状態において流れる IC 単体の電流を示します。

2.5 最大出力電圧(High) / 最大出力電圧(Low) (V_{OH}/V_{OL})
規定の負荷条件で IC が出力できる電圧範囲を示します。一般的に最大出力電圧 High と Low に分けられます。
最大出力電圧(High)は出力電圧の上限を示しており、最大出力電圧(Low)は出力電圧の下限を示しています。

2.6 大振幅電圧利得 (A_V)
+入力端子、-入力端子の差電圧に対する出力電圧への増幅率(利得)を示します。
通常、直流電圧に対する増幅率(利得)です。

A_V=(出力電圧) / (差動入力電圧)

2.7 同相入力電圧範囲 (V_{ICM})
IC が正常に動作する入力電圧範囲を示しています。

2.8 同相信号除去比 (CMRR)
同相入力電圧を変化させた時の入力オフセット電圧の変動の比を示しています。通常、直流変動分です。

CMRR=(同相入力電圧変化分) / (入力オフセット電圧変動分)

2.9 電源電圧除去比 (PSRR)
電源電圧を変化させた時の入力オフセット電圧の変動の比を示しています。通常、直流変動分です。

PSRR=(電源電圧変化分) / (入力オフセット電圧変動分)

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

電気的特性用語説明 – 続き

2.10 出力ソース電流 / 出力シンク電流 (I_{SOURCE} / I_{SINK})

規定の出力条件(出力電圧や負荷条件など)で出力できる最大の出力電流を示します。出力ソース電流と出力シンク電流に分けられます。 出力ソース電流は IC からの流出電流を示しており、出力シンク電流は IC への流入電流を示しています。

2.11 スルーレート (SR)

オペアンプの動作速度を表すパラメータです。出力電圧が規定した単位時間当りに変化できる割合を示します。

2.12 利得帯域幅積 (GBW)

利得の傾きが 6dB/octave の領域における任意の周波数と、その利得の積を示しています。

2.13 チャンネルセパレーション (CS)

駆動されたチャンネルの出力電圧の変化に対する他チャンネルの出力電圧の変動を示します。

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ

○BA82904Yxxx-C

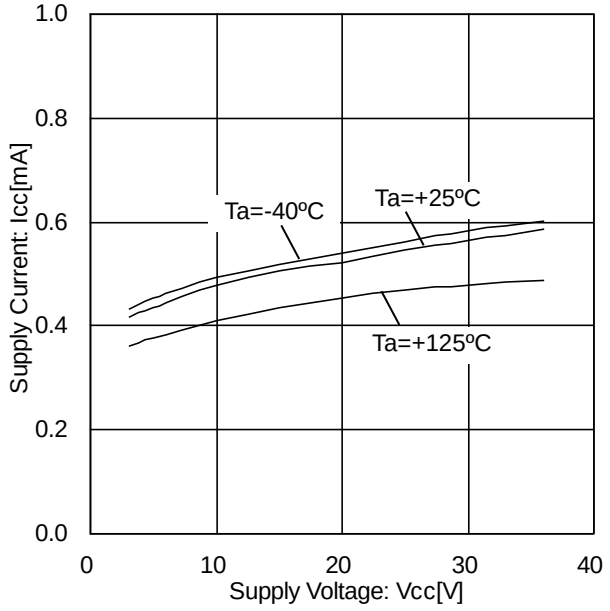


Figure 2. Supply Current vs Supply Voltage

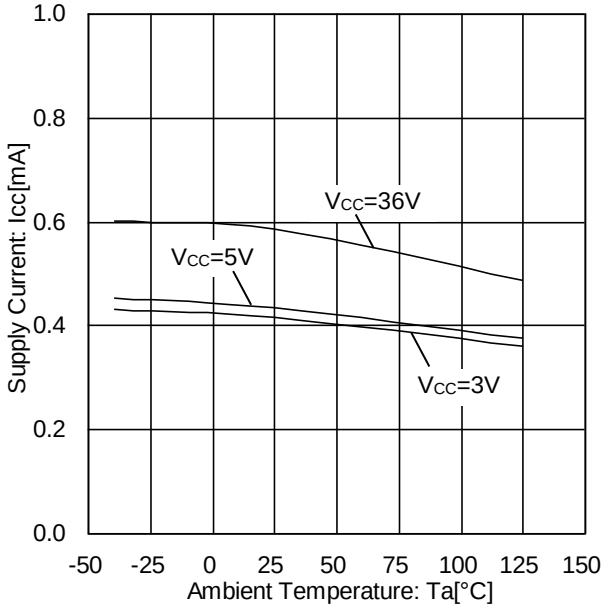


Figure 3. Supply Current vs Ambient Temperature

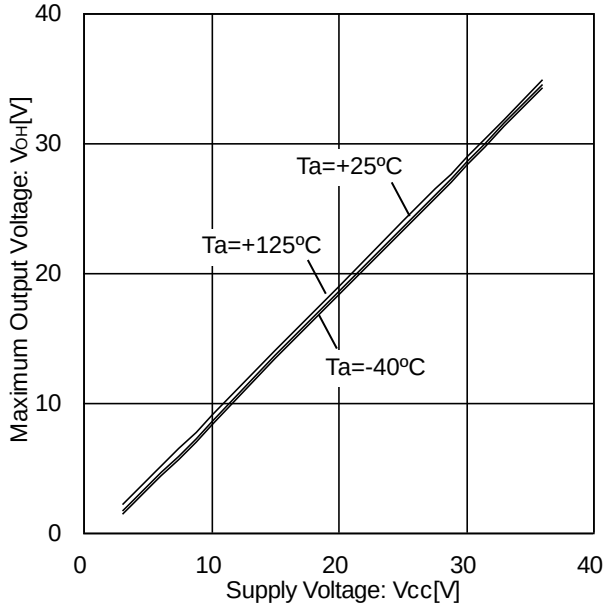


Figure 4. Maximum Output Voltage vs Supply Voltage
(R_L=10kΩ)

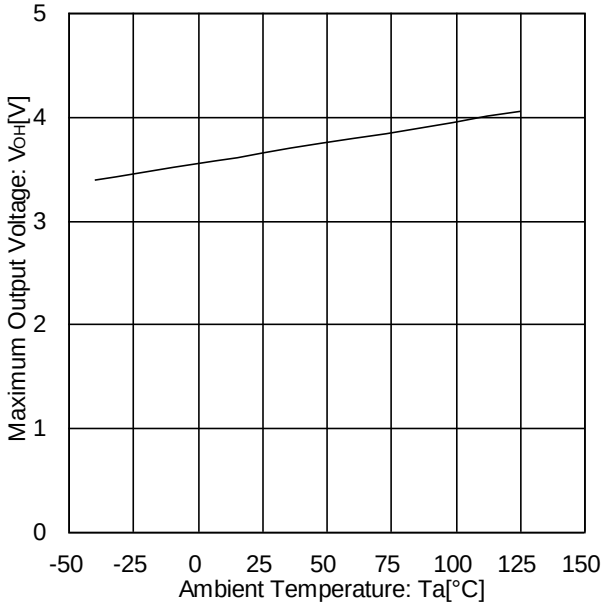


Figure 5. Maximum Output Voltage vs Ambient Temperature
(V_{CC}=5V, R_L=2kΩ)

(Note) 上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ – 続き

○BA82904Yxxx-C

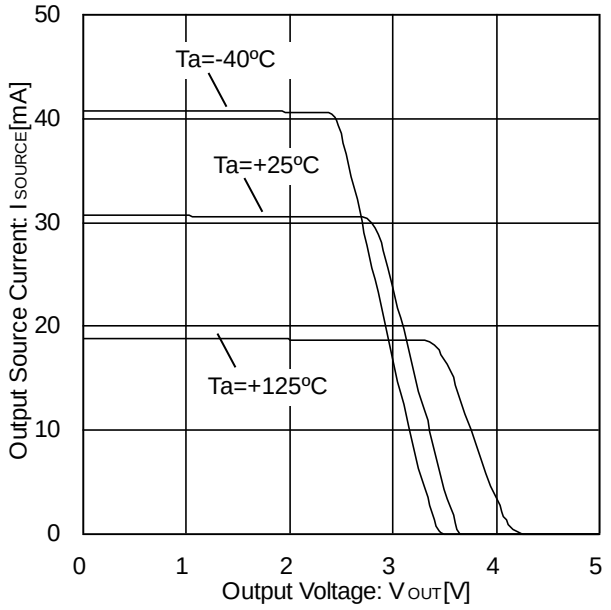


Figure 6. Output Source Current vs Output Voltage
(V_{CC}=5V)

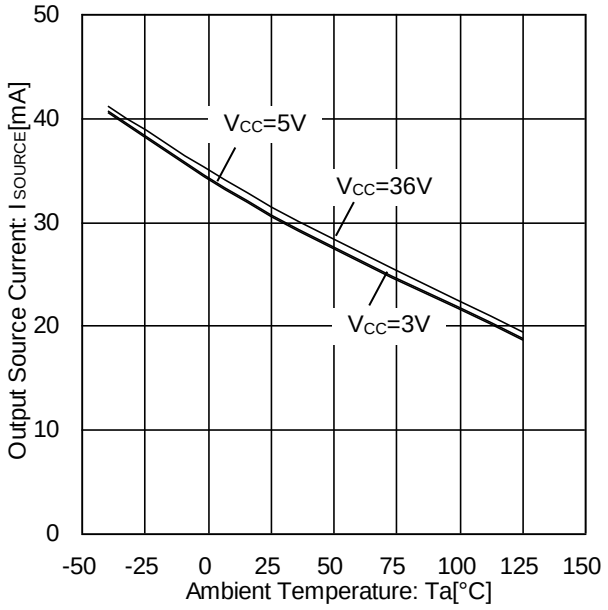


Figure 7. Output Source Current vs Ambient Temperature
(V_{OUT}=0V)

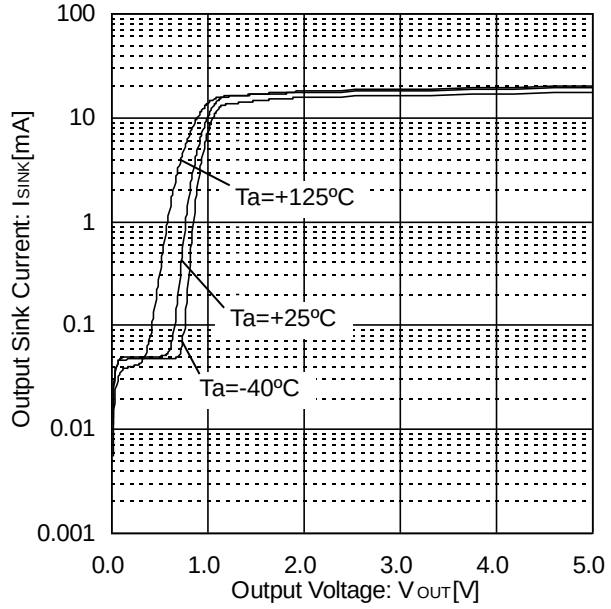


Figure 8. Output Sink Current vs Output Voltage
(V_{CC}=5V)

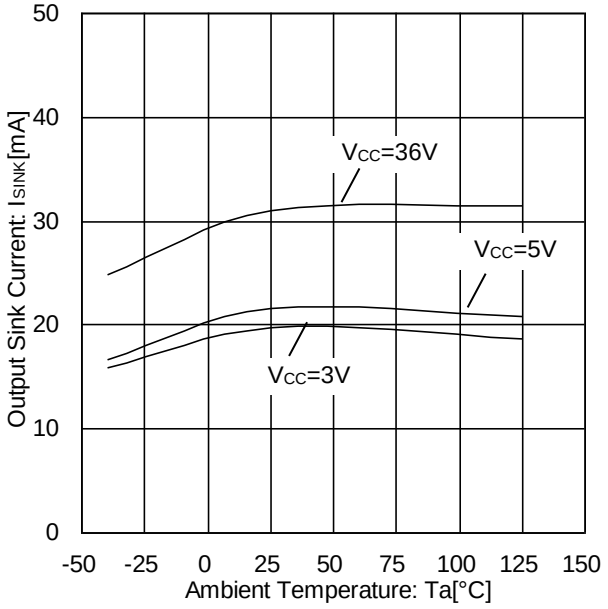


Figure 9. Output Sink Current vs Ambient Temperature
(V_{OUT}=V_{CC})

(Note) 上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ – 続き

○BA82904Yxxx-C

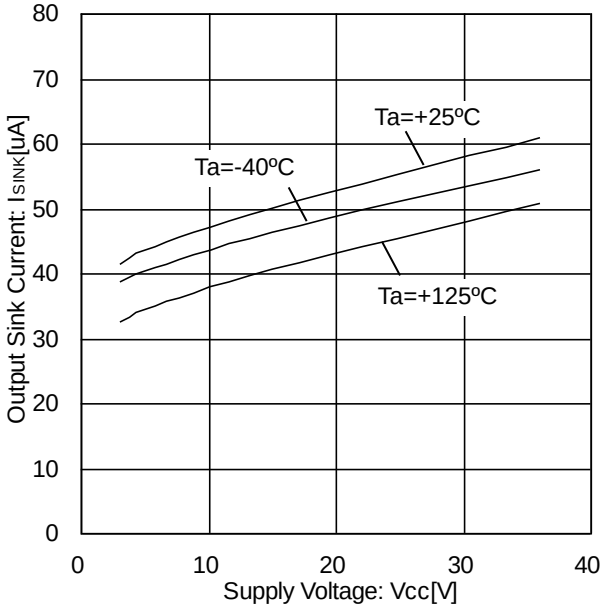


Figure 10. Output Sink Current vs Supply Voltage
(V_{OUT}=0.2V)

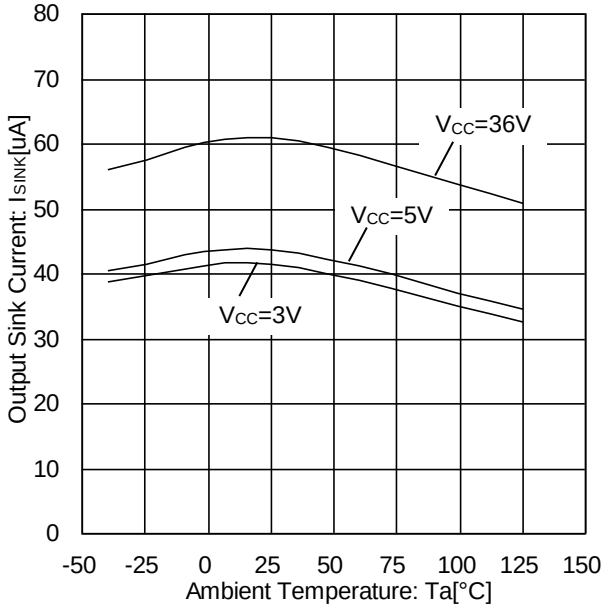


Figure 11. Output Sink Current vs Ambient Temperature
(V_{OUT}=0.2V)

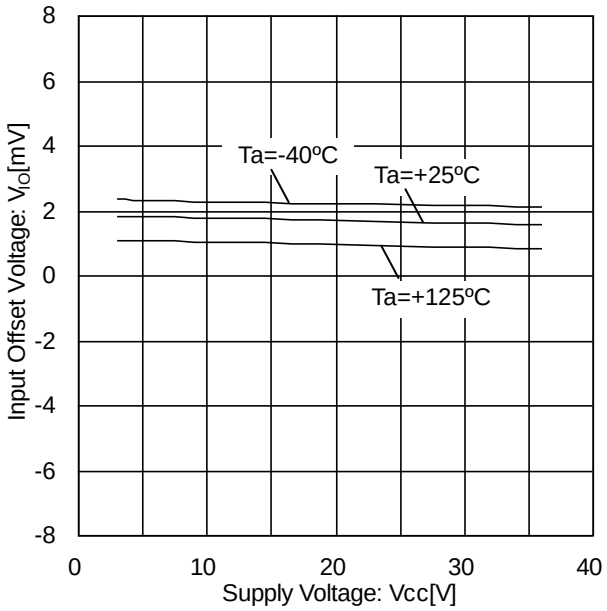


Figure 12. Input Offset Voltage vs Supply Voltage
(V_{ICM}=0V, V_{OUT}=1.4V)

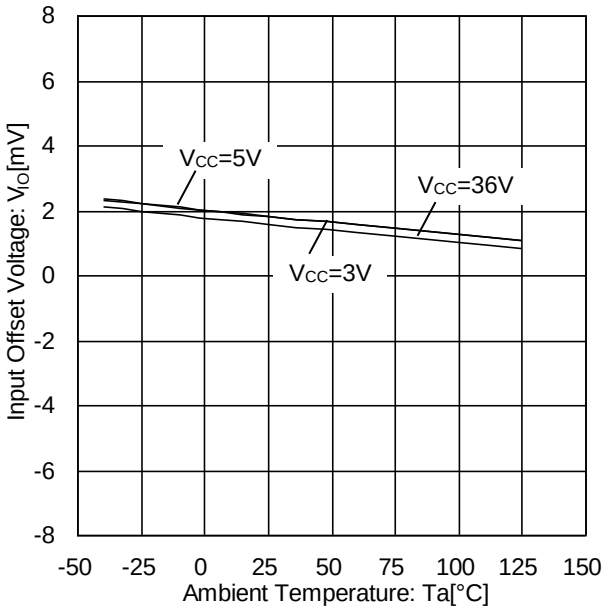


Figure 13. Input Offset Voltage vs Ambient Temperature
(V_{ICM}=0V, V_{OUT}=1.4V)

(Note) 上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ – 続き

○BA82904Yxxx-C

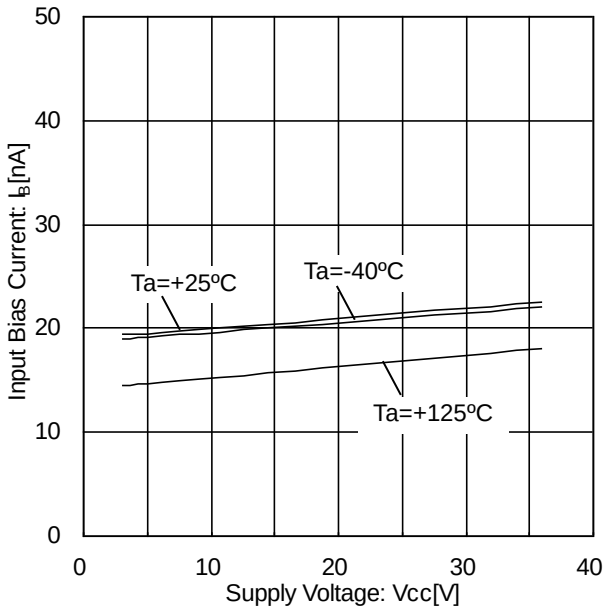


Figure 14. Input Bias Current vs Supply Voltage
(V_{ICM}=0V, V_{OUT}=1.4V)

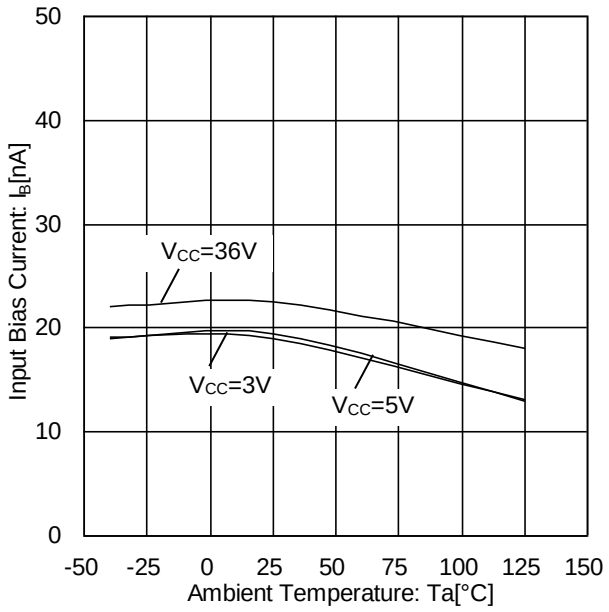


Figure 15. Input Bias Current vs Ambient Temperature
(V_{ICM}=0V, V_{OUT}=1.4V)

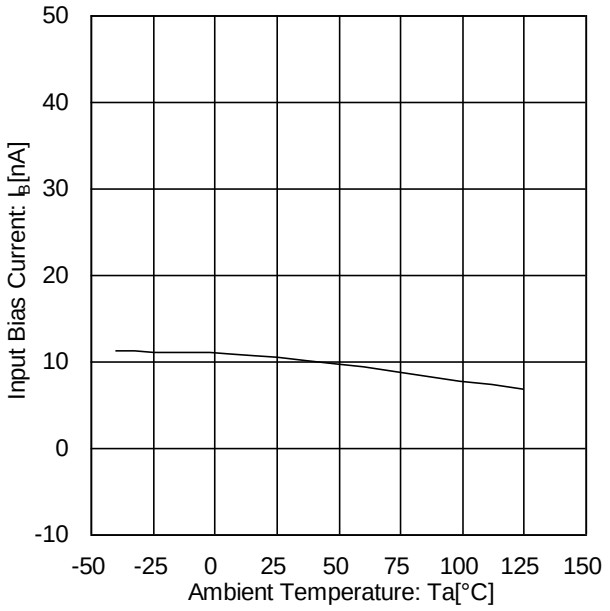


Figure 16. Input Bias Current vs Ambient Temperature
(V_{CC}=30V, V_{ICM}=28V, V_{OUT}=1.4V)

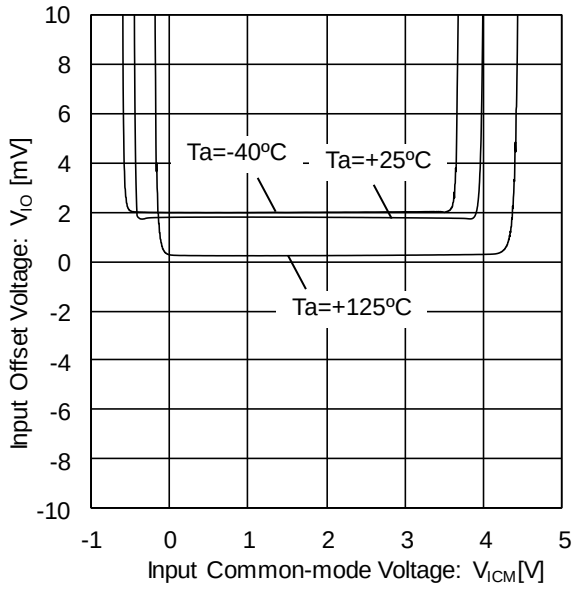


Figure 17. Input Offset Voltage vs
Input Common-mode Voltage
(V_{CC}=5V)

(Note) 上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ – 続き

○BA82904Yxxx-C

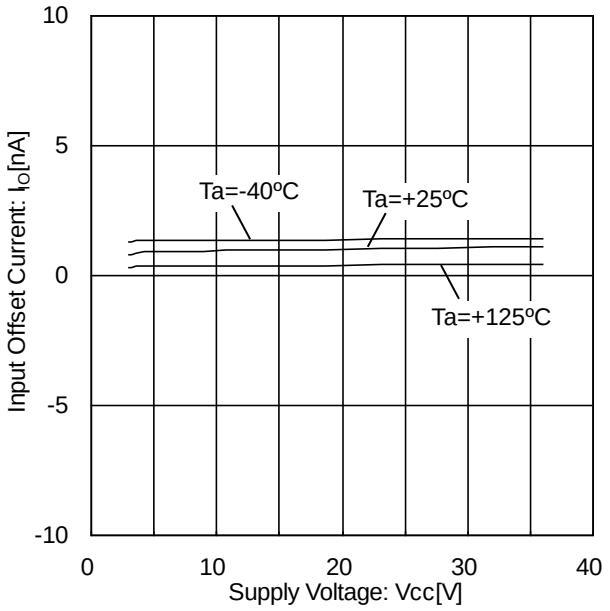


Figure 18. Input Offset Current vs Supply Voltage
(V_{ICM}=0V, V_{OUT}=1.4V)

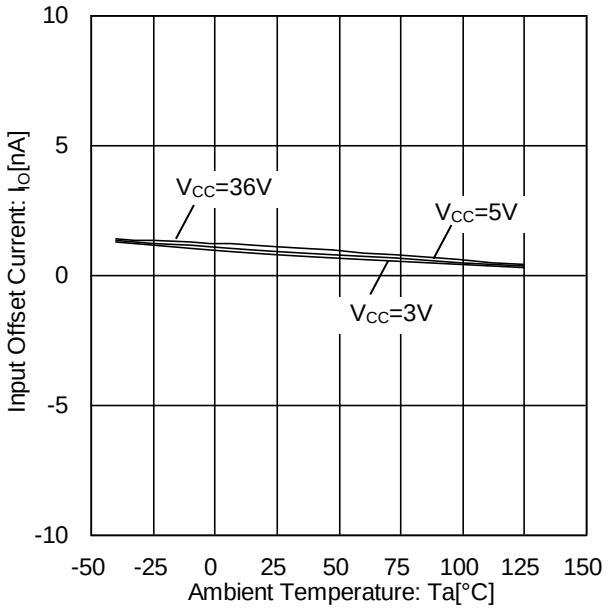


Figure 19. Input Offset Current vs Ambient Temperature
(V_{ICM}=0V, V_{OUT}=1.4V)

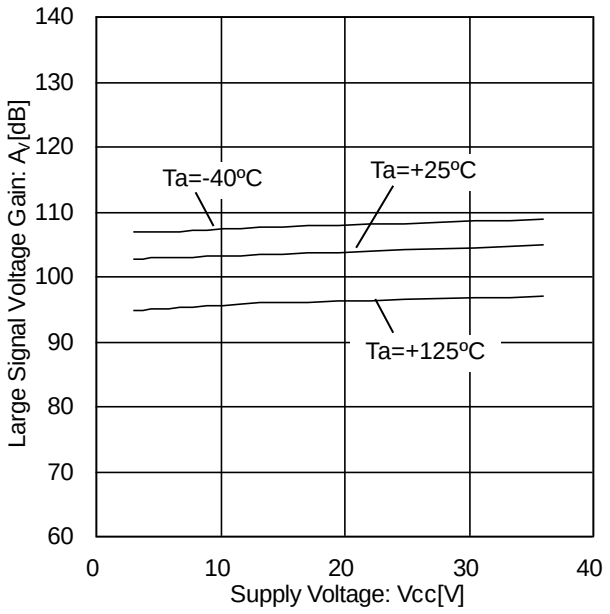


Figure 20. Large Signal Voltage Gain vs Supply Voltage
(R_L=2kΩ)

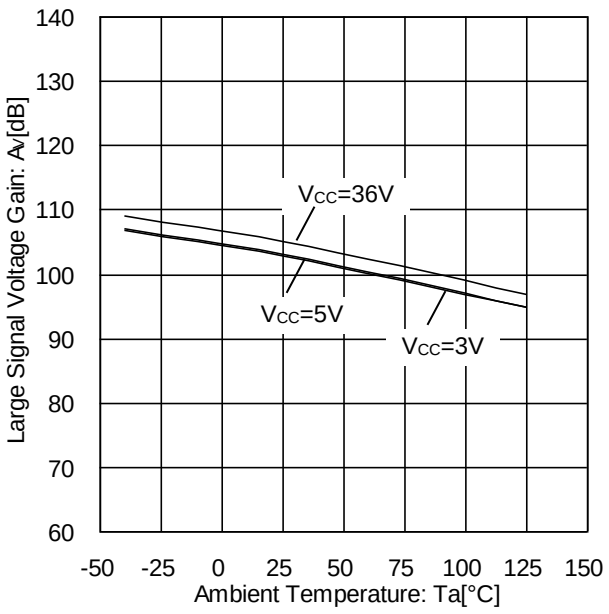


Figure 21. Large Signal Voltage Gain vs Ambient Temperature
(R_L=2kΩ)

(Note) 上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ – 続き

○BA82904Yxxx-C

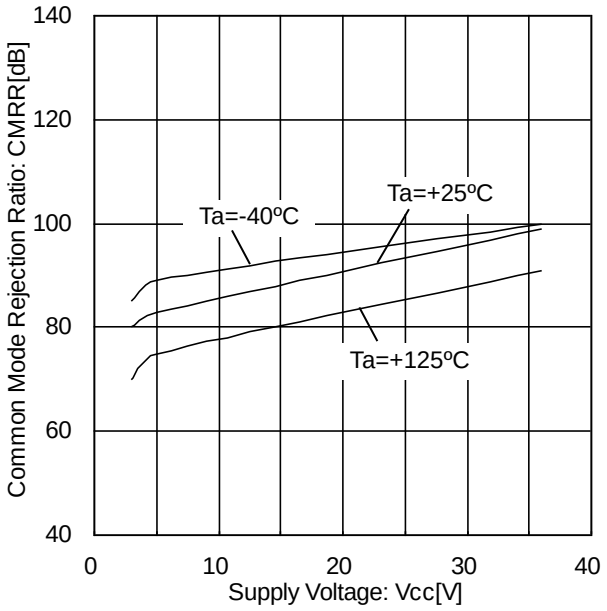


Figure 22. Common Mode Rejection Ratio vs Supply Voltage
(V_{OUT}=1.4V)

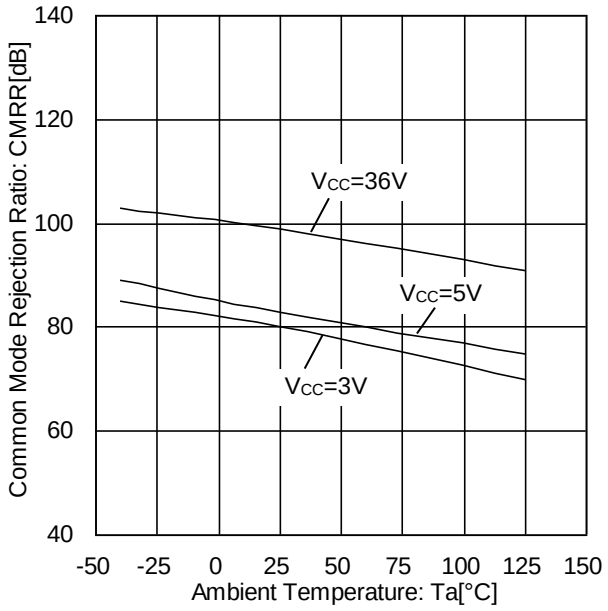


Figure 23. Common Mode Rejection Ratio vs Ambient Temperature
(V_{OUT}=1.4V)

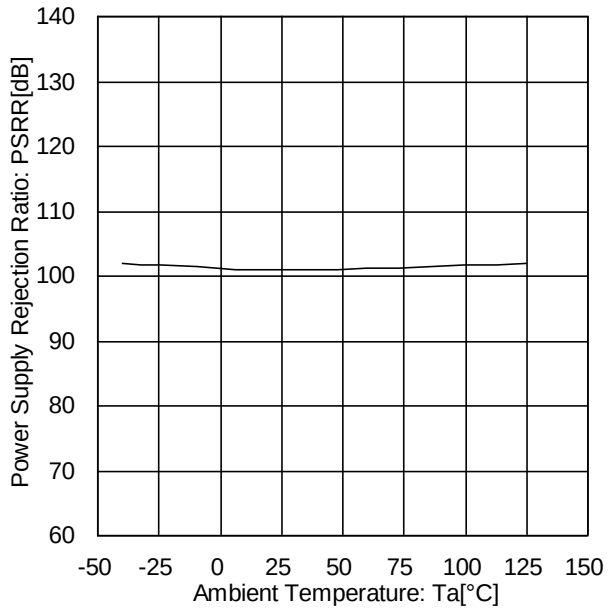


Figure 24. Power Supply Rejection Ratio vs Ambient Temperature
(V_{CC}=5V)

(Note) 上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ – 続き

○BA82902Yxxx-C

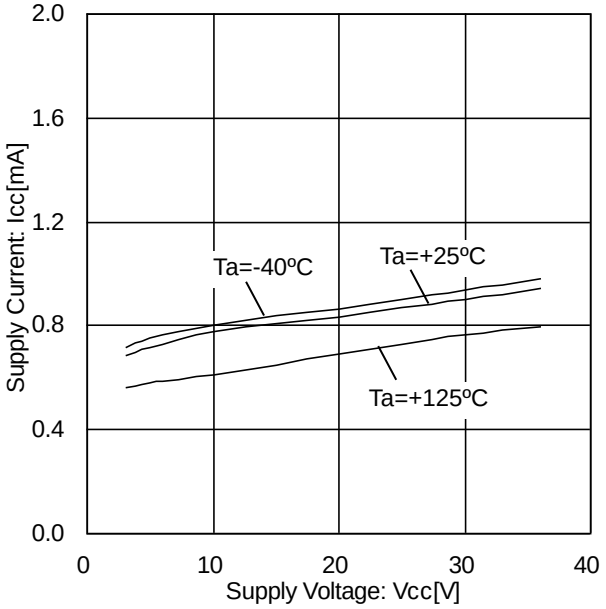


Figure 25. Supply Current vs Supply Voltage

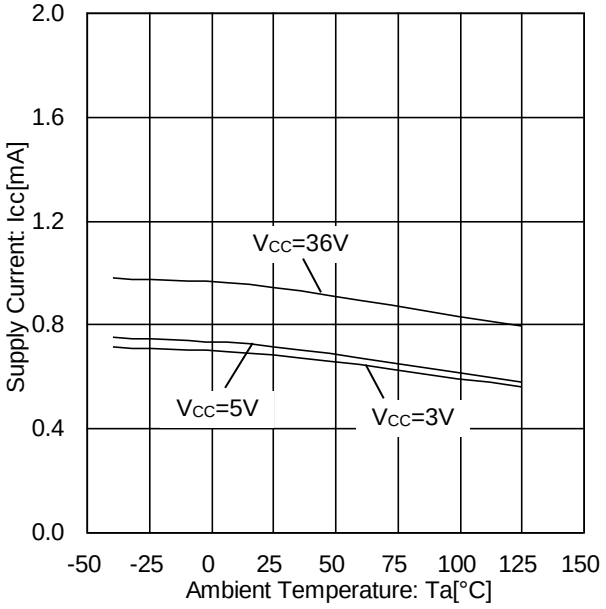


Figure 26. Supply Current vs Ambient Temperature

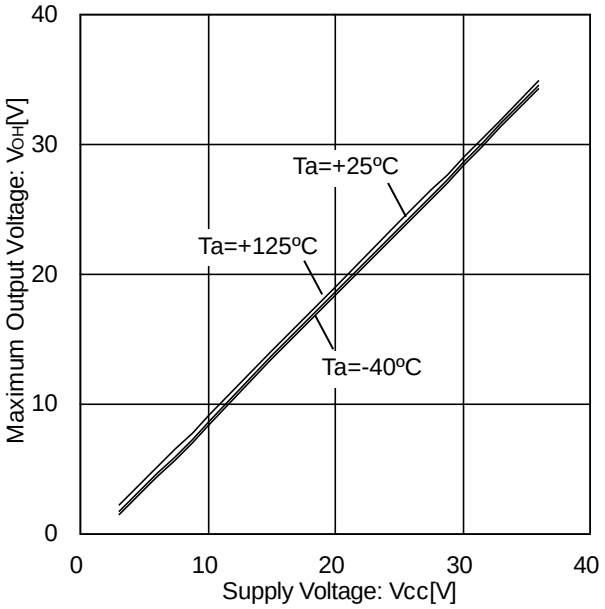


Figure 27. Maximum Output Voltage vs Supply Voltage
(R_L=10kΩ)

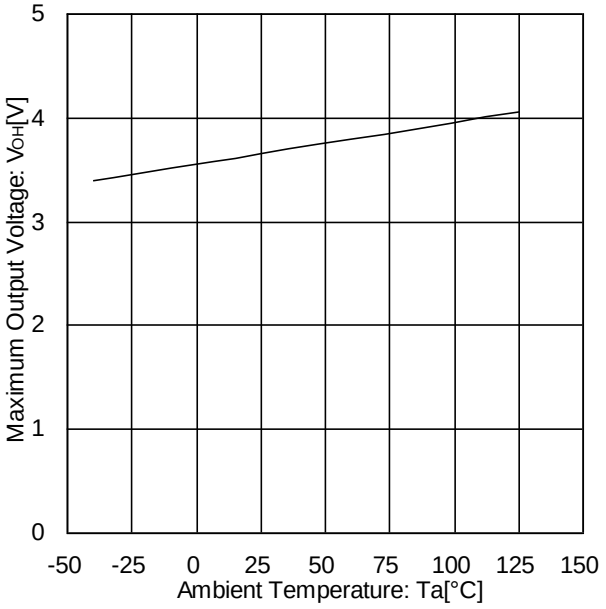


Figure 28. Maximum Output Voltage vs Ambient Temperature
(V_{CC}=5V, R_L=2kΩ)

(Note) 上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ – 続き

○BA82902Yxxx-C

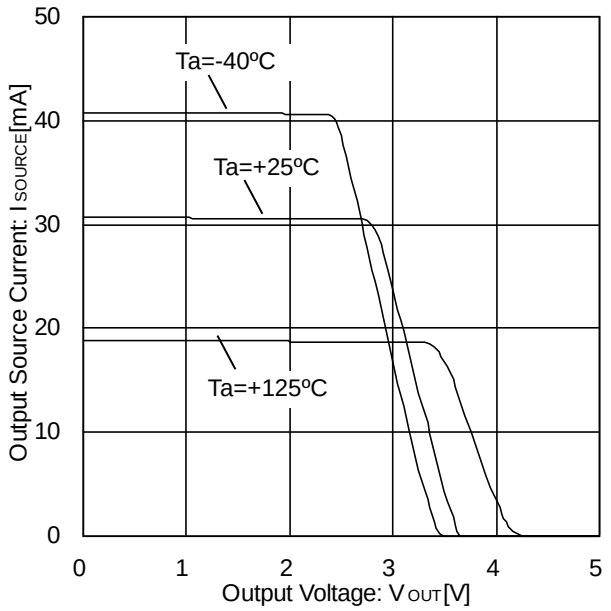


Figure 29. Output Source Current vs Output Voltage
(V_{CC}=5V)

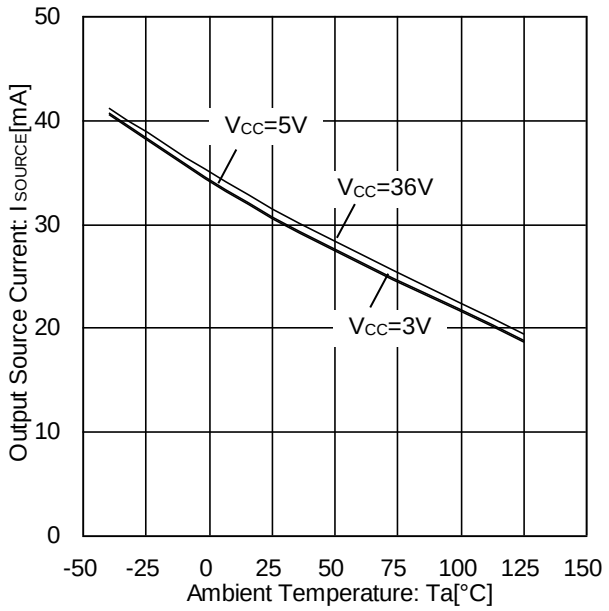


Figure 30. Output Source Current vs Ambient Temperature
(V_{OUT}=0V)

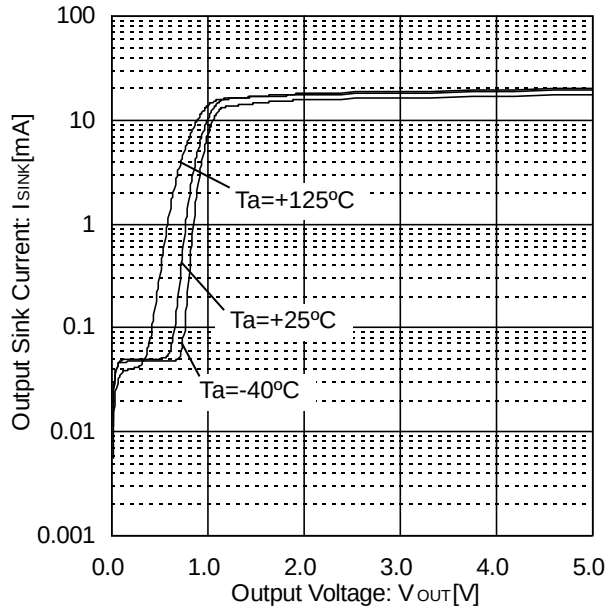


Figure 31. Output Sink Current vs Output Voltage
(V_{CC}=5V)

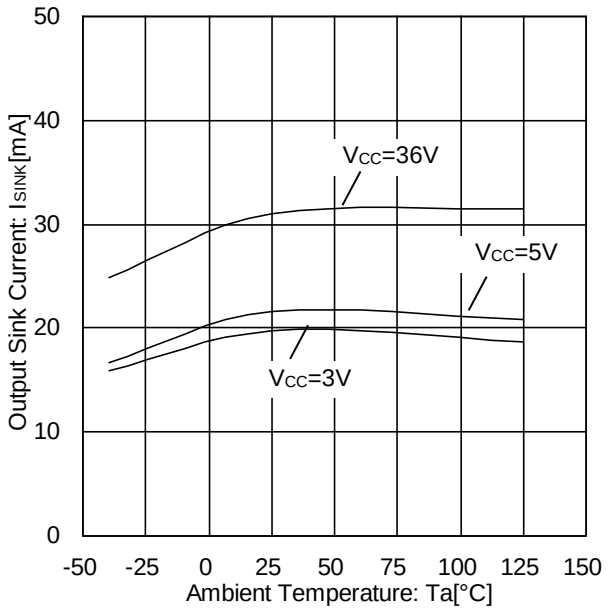


Figure 32. Output Sink Current vs Ambient Temperature
(V_{OUT}=V_{CC})

(Note) 上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ – 続き

○BA82902Yxxx-C

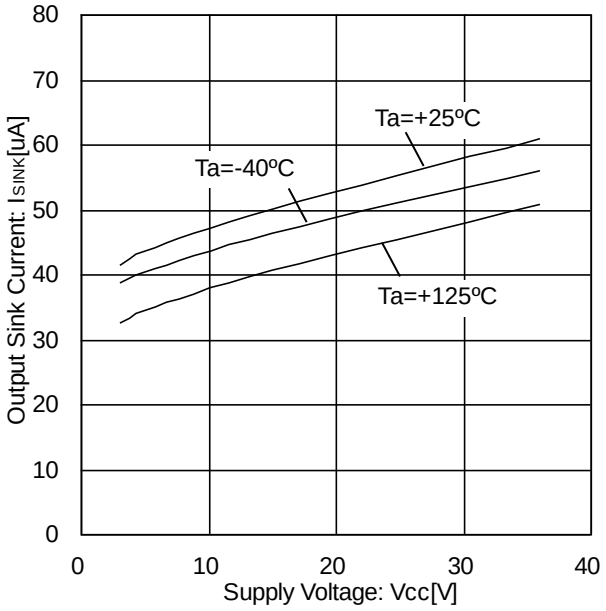


Figure 33. Output Sink Current vs Supply Voltage
(V_{OUT}=0.2V)

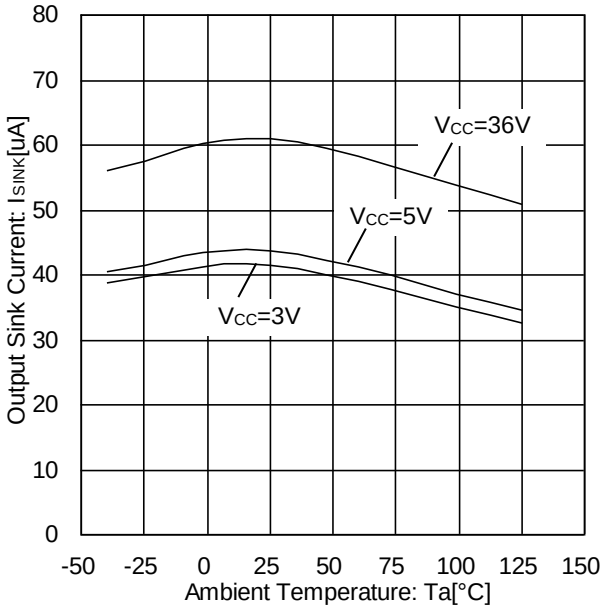


Figure 34. Output Sink Current vs Ambient Temperature
(V_{OUT}=0.2V)

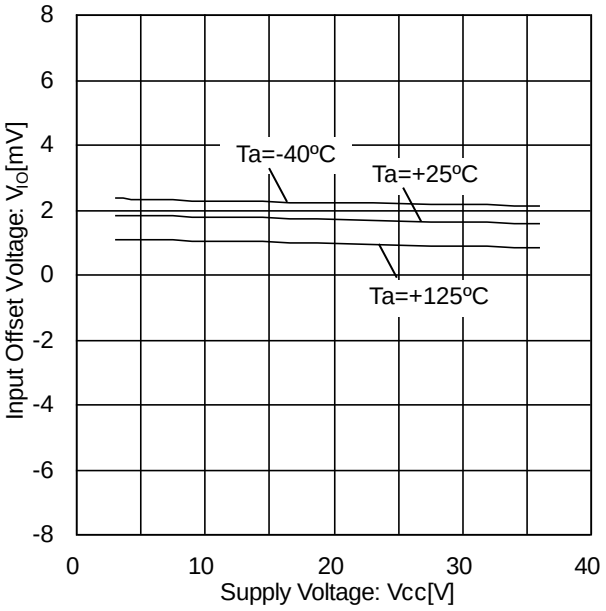


Figure 35. Input Offset Voltage vs Supply Voltage
(V_{ICM}=0V, V_{OUT}=1.4V)

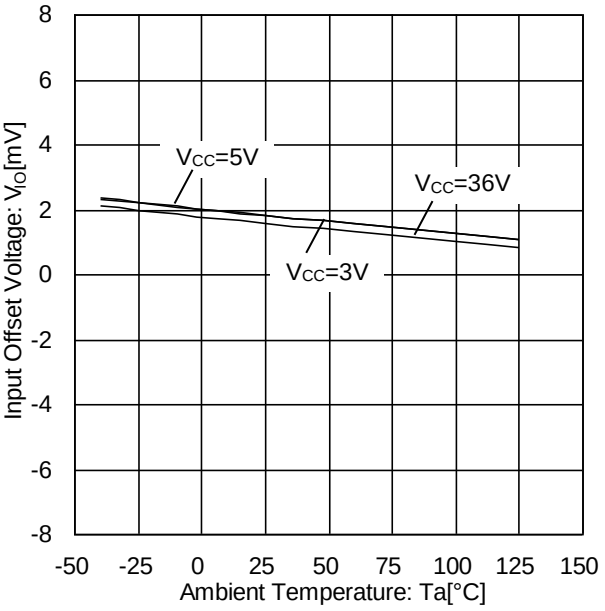


Figure 36. Input Offset Voltage vs Ambient Temperature
(V_{ICM}=0V, V_{OUT}=1.4V)

(Note) 上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ – 続き

○BA82902Yxxx-C

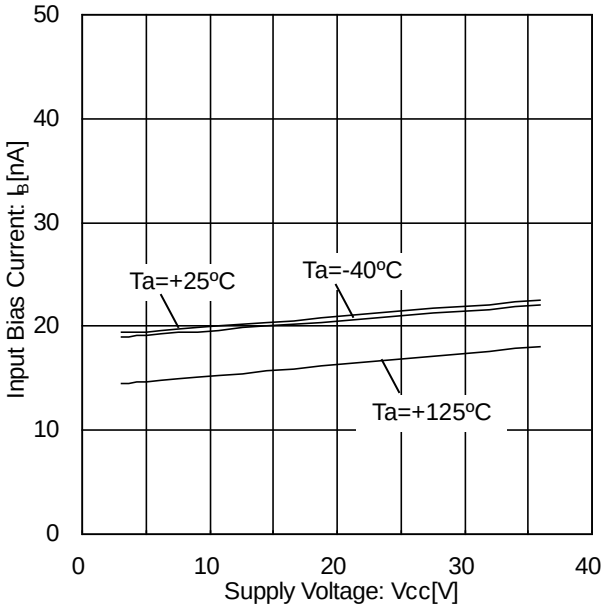


Figure 37. Input Bias Current vs Supply Voltage
(V_{ICM}=0V, V_{OUT}=1.4V)

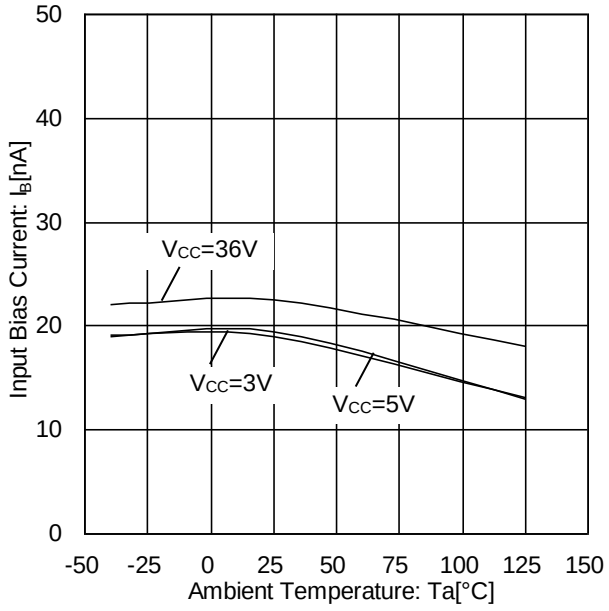


Figure 38. Input Bias Current vs Ambient Temperature
(V_{ICM}=0V, V_{OUT}=1.4V)

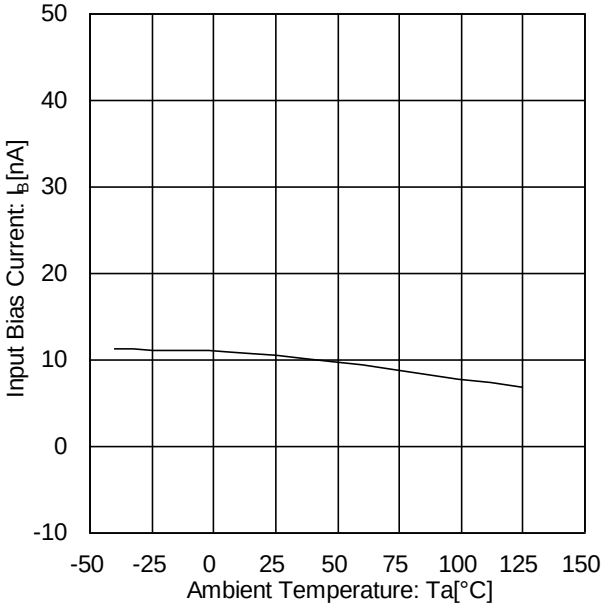


Figure 39. Input Bias Current vs Ambient Temperature
(V_{CC}=30V, V_{ICM}=28V, V_{OUT}=1.4V)

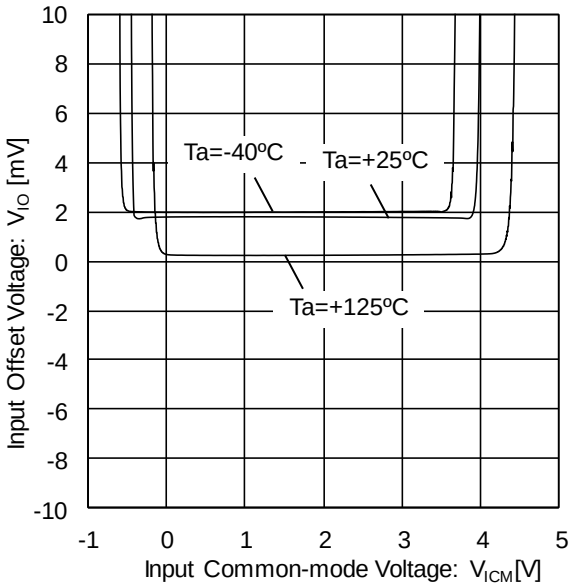


Figure 40. Input Offset Voltage vs
Input Common-mode Voltage
(V_{CC}=5V)

(Note) 上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ – 続き

○BA82902Yxxx-C

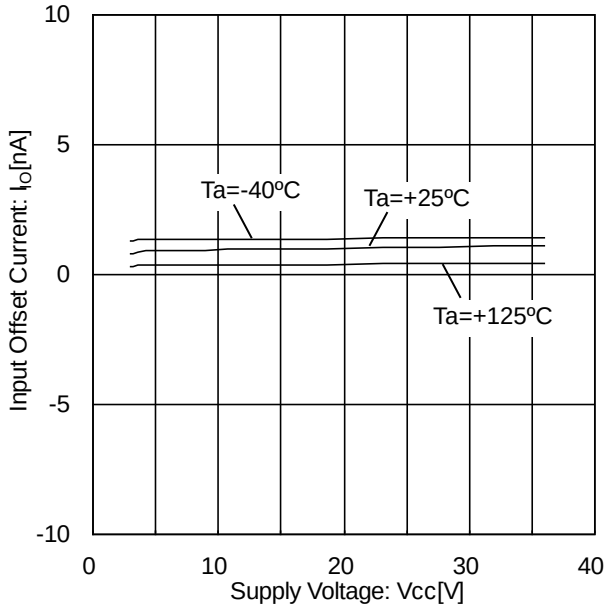


Figure 41. Input Offset Current vs Supply Voltage
(V_{ICM}=0V, V_{OUT}=1.4V)

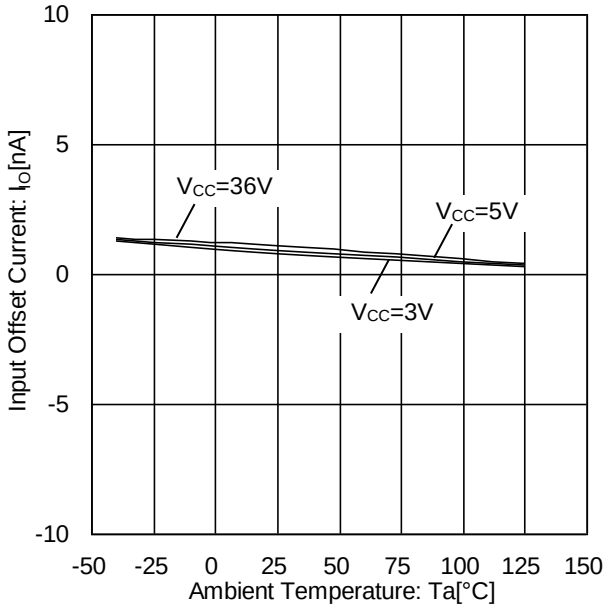


Figure 42. Input Offset Current vs Ambient Temperature
(V_{ICM}=0V, V_{OUT}=1.4V)

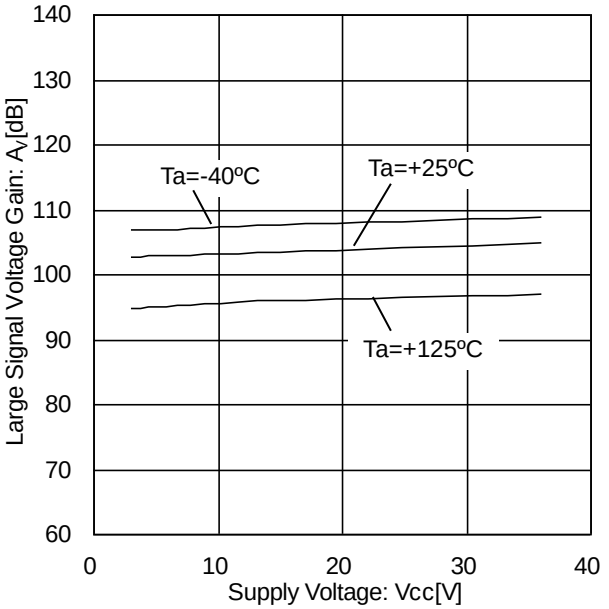


Figure 43. Large Signal Voltage Gain vs Supply Voltage
(R_L=2kΩ)

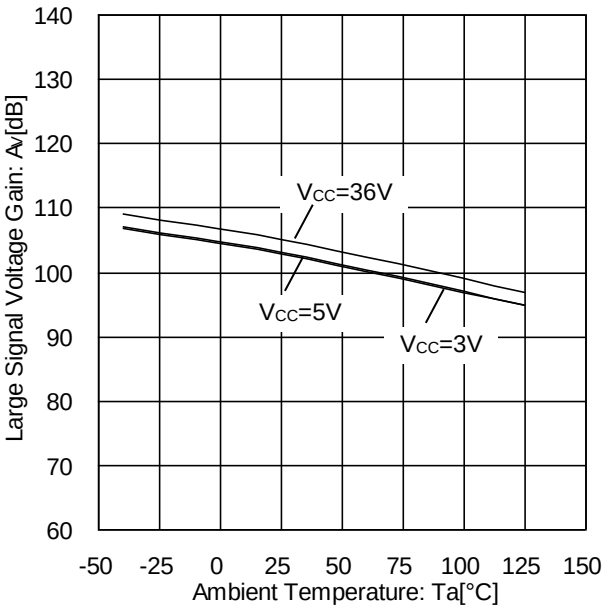


Figure 44. Large Signal Voltage Gain vs Ambient Temperature
(R_L=2kΩ)

(Note) 上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ – 続き

○BA82902Yxxx-C

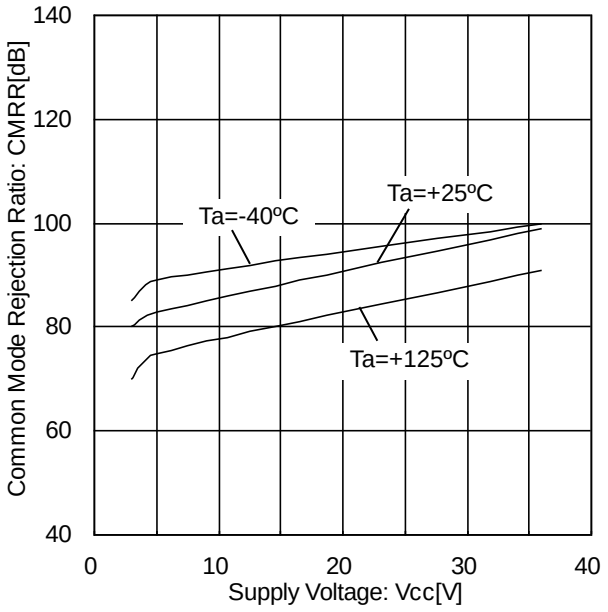


Figure 45. Common Mode Rejection Ratio vs Supply Voltage
(V_{OUT}=1.4V)

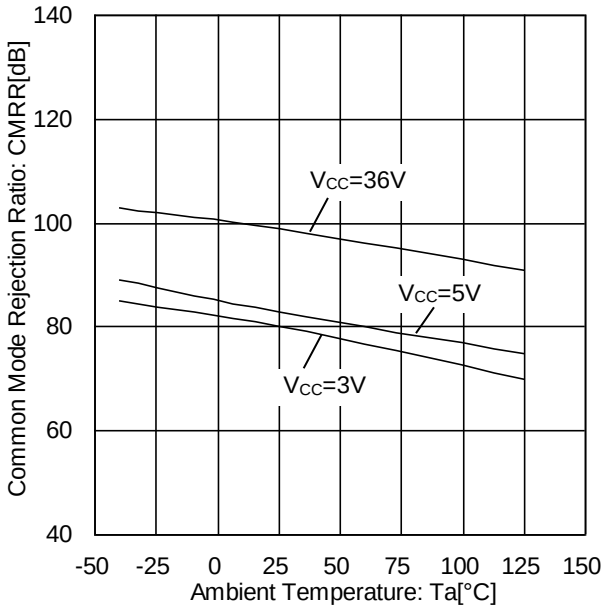


Figure 46. Common Mode Rejection Ratio vs Ambient Temperature
(V_{OUT}=1.4V)

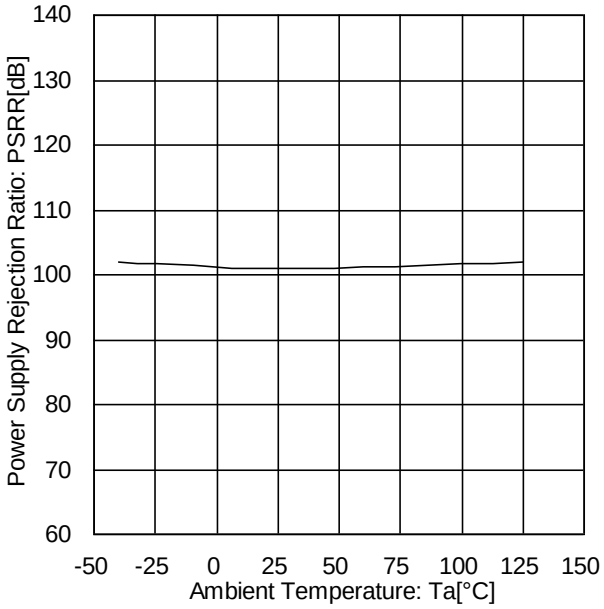


Figure 47. Power Supply Rejection Ratio vs Ambient Temperature
(V_{CC}=5V)

(Note) 上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

アプリケーションヒント

測定回路 1，測定条件

V_{CC}, V_{EE}, V_{EK}, V_{ICM} の単位:V

測定項目	V_F	SW1	SW2	SW3	V_{CC}	V_{EE}	V_{EK}	V_{ICM}	計算式
入力オフセット電圧	V_{F1}	ON	ON	OFF	5～30	0	-1.4	0	1
入力オフセット電流	V_{F2}	OFF	OFF	OFF	5	0	-1.4	0	2
入力バイアス電流	V_{F3}	OFF	ON	OFF	5	0	-1.4	0	3
	V_{F4}	ON	OFF						
大振幅電圧利得	V_{F5}	ON	ON	ON	15	0	-1.4	0	4
	V_{F6}				15	0	-11.4	0	
同相信号除去比 (同相入力電圧範囲)	V_{F7}	ON	ON	OFF	5	0	-1.4	0	5
	V_{F8}				5	0	-1.4	3.5	
電源電圧除去比	V_{F9}	ON	ON	OFF	5	0	-1.4	0	6
	V_{F10}				30	0	-1.4	0	

-計算式-

1.入力オフセット電圧 (V_{IO})

$$V_{IO} = \frac{|V_{F1}|}{1 + R_F / R_S} \quad [V]$$

2.入力オフセット電流 (I_{IO})

$$I_{IO} = \frac{|V_{F2} - V_{F1}|}{R_I \times (1 + R_F / R_S)} \quad [A]$$

3.入力バイアス電流 (I_B)

$$I_B = \frac{|V_{F4} - V_{F3}|}{2 \times R_I \times (1 + R_F / R_S)} \quad [A]$$

4.大振幅電圧利得 (A_V)

$$A_V = 20 \times Log \frac{\Delta V_{EK} \times (1 + R_F / R_S)}{|V_{F5} - V_{F6}|} \quad [dB]$$

5.同相信号除去比 (CMRR)

$$CMRR = 20 \times Log \frac{\Delta V_{ICM} \times (1 + R_F / R_S)}{|V_{F8} - V_{F7}|} \quad [dB]$$

6.電源電圧除去比 (PSRR)

$$PSRR = 20 \times Log \frac{\Delta V_{CC} \times (1 + R_F / R_S)}{|V_{F10} - V_{F9}|} \quad [dB]$$

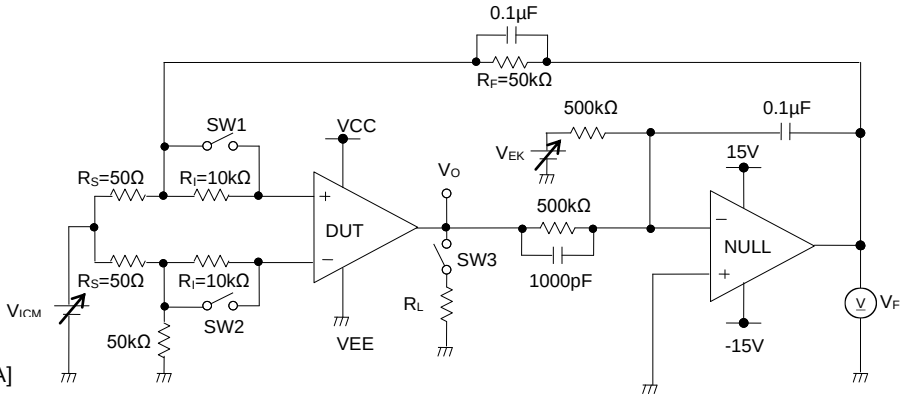


Figure 48. 測定回路 1 (1 チャンネルのみ)

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

アプリケーションヒント – 続き

測定回路 2 , SW 条件

SW No.	SW 1	SW 2	SW 3	SW 4	SW 5	SW 6	SW 7	SW 8	SW 9	SW 10	SW 11	SW 12	SW 13	SW 14
回路電流	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
最大出力電圧(High)	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
最大出力電圧(Low)	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
出力ソース電流	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
出力シンク電流	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
スルーレート	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
利得帯域幅積	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
入力換算雑音電圧	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF

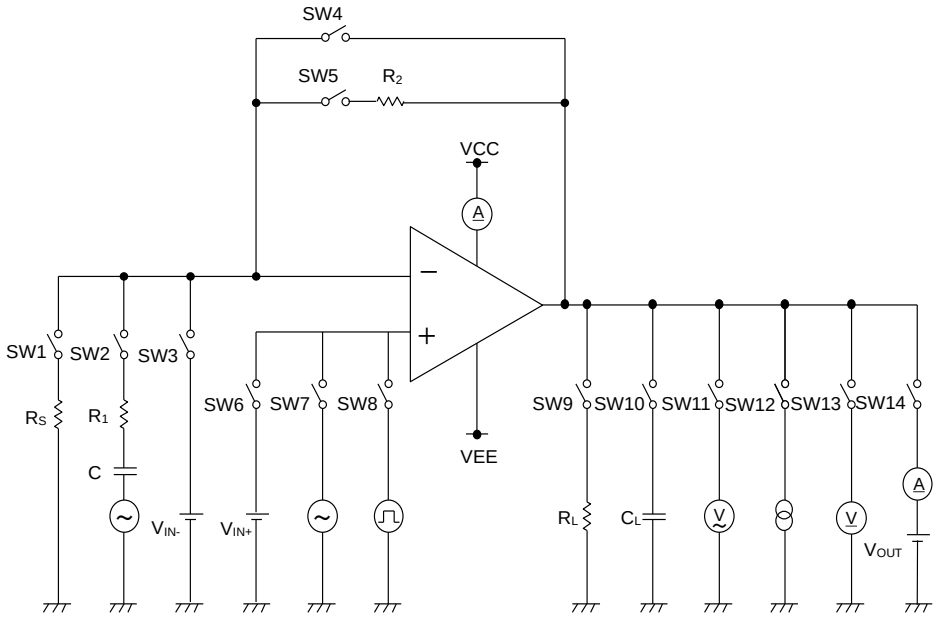


Figure 49. 測定回路 2 (片チャンネルのみ)

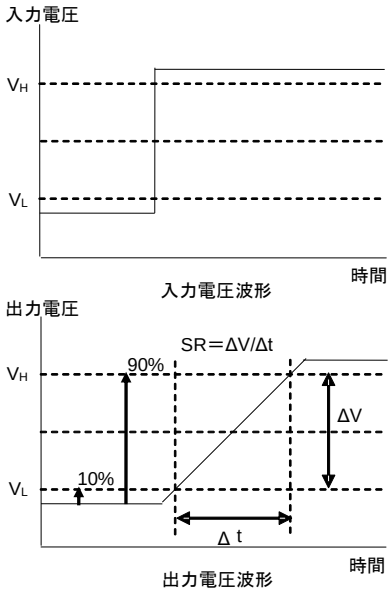


Figure 50. スルーレート測定時波形

測定回路 3 , チャンネルセパレーション測定条件

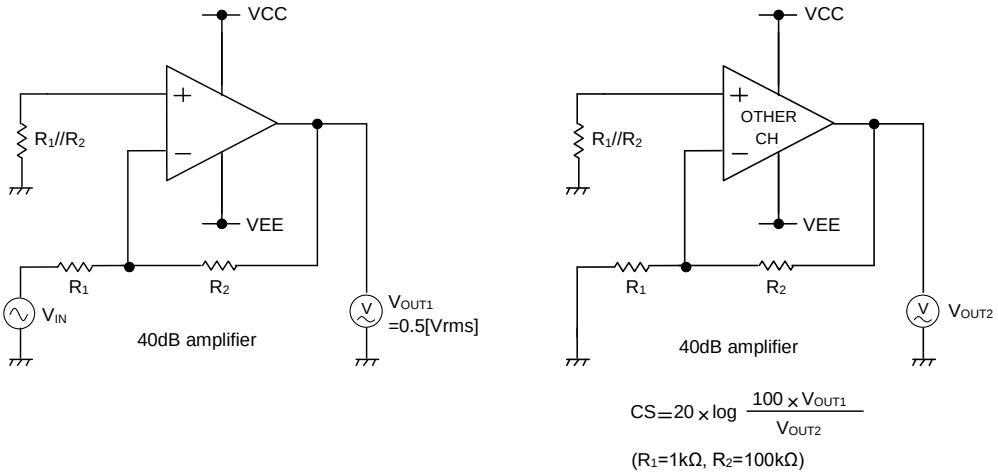


Figure 51. 測定回路 3

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

アプリケーションヒント – 続き

EMI 耐量について

BA82904Yxxx-C, BA82902Yxxx-C は EMI フィルタ内蔵のため外部からの電磁波干渉に対する耐性が高く、EMI 設計も容易です。従来品からの置き換えに最適です。ROHM 製基板、IC 単体での特性データは以下のようになります。試験条件は ISO11452-2 の規格に準拠しております。

<試験条件>　ISO11452-2 に準拠
測定回路：ボルテージフォロア
V_{CC}：12V
V_{IN+}：6V
試験方法：置換法（進行波電力）
電界強度：200V/m
試験波：CW (連続波)
周波数：200MHz – 1000MHz (2% step)

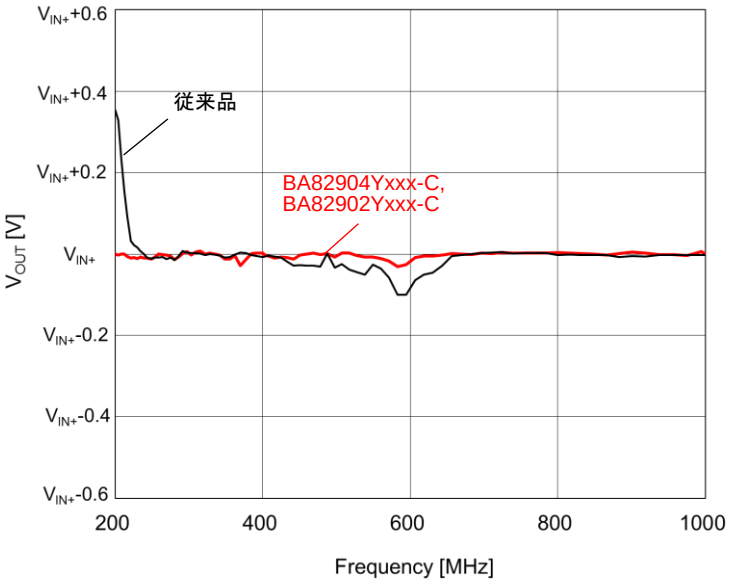


Figure 52. EMI 特性データ

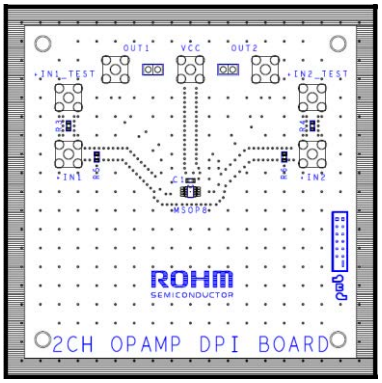


Figure 53. EMI 特性評価ボード(BA82904Yxxx-C)

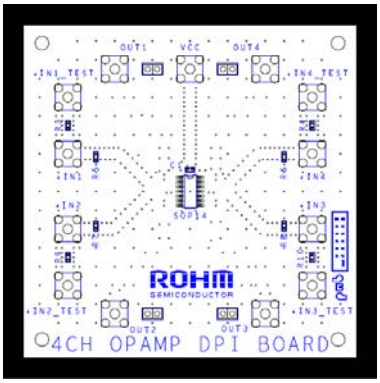


Figure 54. EMI 特性評価ボード(BA82902Yxxx-C)

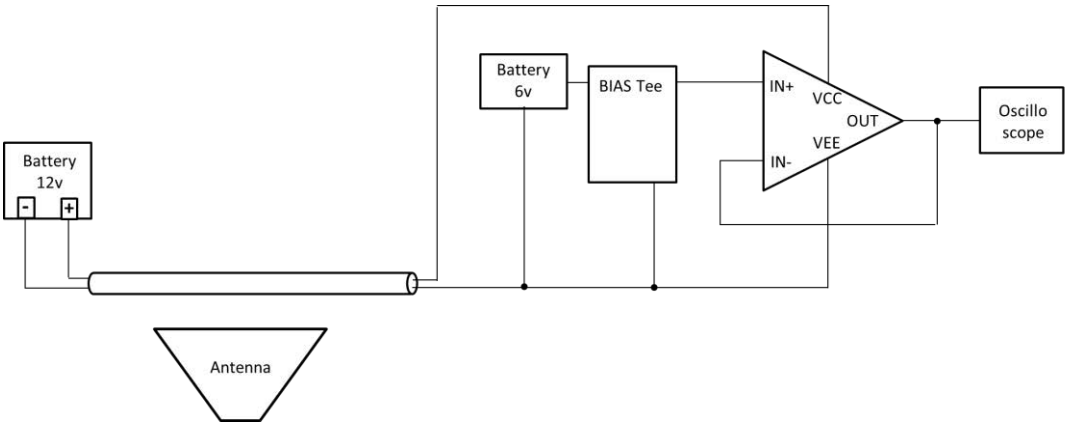


Figure 55. EMI 特性測定回路図

(Note) 上記のデータは ROHM 基板で測定した代表的な IC 単体の測定値であり、保証するものではありません。
実アプリケーションでは十分な設計・評価をお願いいたします。

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

アプリケーションヒント – 続き

1. 未使用回路の処理
   使用しない回路がある場合は、Figure 56 のように接続し、非反転入力端子を同相入力電圧範囲(V_{ICM})内の電位にすることをお勧めします。

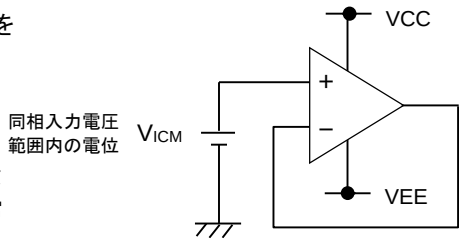


Figure 56. 未使用回路の処理例

2. 入力端子の印加電圧について
   入力端子に対しては、電源電圧にかかわらず V_{EE}+36V の電圧を特性劣化や破壊がなく印加可能です。ただしこれは回路動作を保証するものではありません。電気的特性の同相入力電圧範囲内の入力電圧でなければ、回路は正常に動作しませんのでご注意ください。

3. 使用電源 (両電源 / 単電源)について
   オペアンプは VCC-VEE 間に所定の電圧が印加されていれば動作します。
   したがって単電源オペアンプは両電源オペアンプとしても使用可能です。

4. 出力の動作について
   本 IC は出力段が C 級プッシュプル回路で構成されております。そのため負荷抵抗が V_{CC}、V_{EE} の中間電位に接続される場合などにおいて、出力電流の吐き出し、吸い込みの切り換わりに、クロスオーバー歪が発生します。出力端子と VEE 間に抵抗器を接続し、バイアス電流を増加して A 級動作にすることでクロスオーバー歪を抑制できます。

5. 出力コンデンサについて
   出力端子に接続される外付けコンデンサに電荷が蓄積された状態で VCC 端子が V_{EE}(GND)電位にショートされた場合、蓄積電荷は回路内部の寄生素子あるいは端子保護素子を通り、VCC 端子に放電されるため回路内部の素子が損傷(熱破壊)する恐れがあります。本 IC を電圧比較器として使用する場合など、負帰還回路を構成せず、出力容量性負荷による発振現象が発生しないアプリケーション回路として使用する場合、上記出力端子に接続されるコンデンサの蓄積電荷による IC の損傷を防ぐため、出力端子に接続するコンデンサは 0.1μF 以下としてください。

6. 出力コンデンサによる発振について
   本 IC を使用して負帰還回路を構成した応用回路を設計する場合、容量性負荷による発振について十分な確認を行ってください。

7. IC の取り扱いについて
   基板の反りや曲がりなどにより IC に応力が加わると、ピエゾ抵抗効果により特性が変動する可能性があります。
   基板の反りや曲がりにご注意ください。

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

使用上の注意

1. **電源の逆接続について**
電源コネクタの逆接続により LSI が破壊する恐れがあります。逆接続破壊保護用として外部に電源と LSI の電源端子間にダイオードを入れるなどの対策を施してください。

2. **電源ラインについて**
基板パターンの設計においては、電源ラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。グラウンドラインについても、同様のパターン設計を考慮してください。また、LSI のすべての電源端子について電源－グラウンド端子間にコンデンサを挿入するとともに、電解コンデンサ使用の際は、低温で容量低下が起こることなど使用するコンデンサの諸特性に問題ないことを十分ご確認のうえ、定数を決定してください。

3. **グラウンド電位について**
グラウンド端子の電位はいかなる動作状態においても、最低電位になるようにしてください。また実際に過渡現象を含め、グラウンド端子以外のすべての端子がグラウンド以下の電圧にならないようにしてください。

4. **グラウンド配線パターンについて**
小信号グラウンドと大電流グラウンドがある場合、大電流グラウンドパターンと小信号グラウンドパターンは分離し、パターン配線の抵抗分と大電流による電圧変化が小信号グラウンドの電圧を変化させないように、セットの基準点で 1 点アースすることを推奨します。外付け部品のグラウンドの配線パターンも変動しないよう注意してください。グラウンドラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。

5. **推奨動作条件について**
推奨動作条件で規定される範囲で IC の機能・動作を保証します。また、特性値は電気的特性で規定される各項目の条件下においてのみ保証されます。

6. **ラッシュカレントについて**
IC 内部論理回路は、電源投入時に論理不定状態で、瞬間的にラッシュカレントが流れる場合がありますので、電源カップリング容量や電源、グラウンドパターン配線の幅、引き回しに注意してください。

7. **強電磁界中の動作について**
強電磁界中でのご使用では、まれに誤動作する可能性がありますのでご注意ください。

8. **セット基板での検査について**
セット基板での検査時に、インピーダンスの低いピンにコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れがあるので、1 工程ごとに必ず放電を行ってください。静電気対策として、組立工程にはアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。また、検査工程での治具への接続をする際には必ず電源を OFF にしてから接続し、電源を OFF にしてから取り外してください。

9. **端子間ショートと誤装着について**
プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けた場合、IC が破壊する恐れがあります。また、出力と電源及びグラウンド間、出力間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。

10. **未使用の入力端子の処理について**
CMOS トランジスタの入力は非常にインピーダンスが高く、入力端子をオープンにすることで論理不定の状態になります。これにより内部の論理ゲートの p チャネル、n チャネルトランジスタが導通状態となり、不要な電源電流が流れます。また 論理不定により、想定外の動作をすることがあります。よって、未使用の端子は特に仕様書上でうたわれていない限り、適切な電源、もしくはグラウンドに接続するようにしてください。

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

使用上の注意　―　続き

11. 各入力端子について

本 IC はモノリシック IC であり、各素子間に素子分離のための P+アイソレーションと、P 基板を有しています。
この P 層と各素子の N 層とで P-N 接合が形成され、各種の寄生素子が構成されます。
例えば、下図のように、抵抗とトランジスタが端子と接続されている場合、

- ○抵抗では、GND > (端子 A)の時、トランジスタ(NPN)では GND > (端子 B)の時、P-N 接合が寄生ダイオードとして動作します。
- ○また、トランジスタ(NPN)では、GND > (端子 B)の時、前述の寄生ダイオードと近接する他の素子の N 層によって寄生の NPN トランジスタが動作します。

IC の構造上、寄生素子は電位関係によって必然的にできます。寄生素子が動作することにより、回路動作の干渉を引き起こし、誤動作、ひいては破壊の原因ともなり得ます。したがって、入出力端子に GND(P 基板)より低い電圧を印加するなど、寄生素子が動作するような使い方をしないよう十分に注意してください。アプリケーションにおいて電源端子と各端子電圧が逆になった場合、内部回路または素子を損傷する可能性があります。例えば、外付けコンデンサに電荷がチャージされた状態で、電源端子が GND にショートされた場合などです。また、電源端子直列に逆流防止のダイオードもしくは各端子と電源端子間にバイパスのダイオードを挿入することを推奨します。

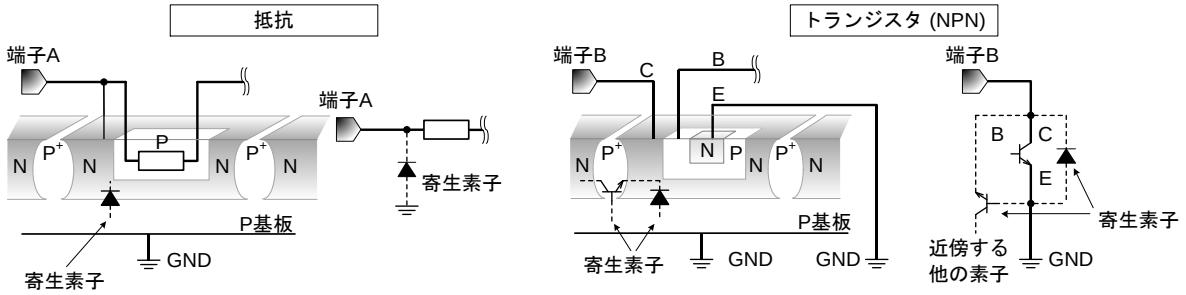


Figure 57. モノリシック IC 構造例

12. セラミック・コンデンサの特性変動について

外付けコンデンサに、セラミック・コンデンサを使用する場合、直流バイアスによる公称容量の低下、及び温度などによる容量の変化を考慮のうえ定数を決定してください。

13. 安全動作領域について

本製品を使用する際には、出力トランジスタが絶対最大定格及び ASO を超えないよう設定してください。

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

発注形名情報

B A 8 2 9 0 x Y x x x - C x x

品番
BA82904Yxxx
BA82902Yxxx

パッケージ
F　: SOP8
　　SOP14
FV　: SSOP-B14
FVM: MSOP8
FJ　: SOP-J14
FVJ : TSSOP-B14J

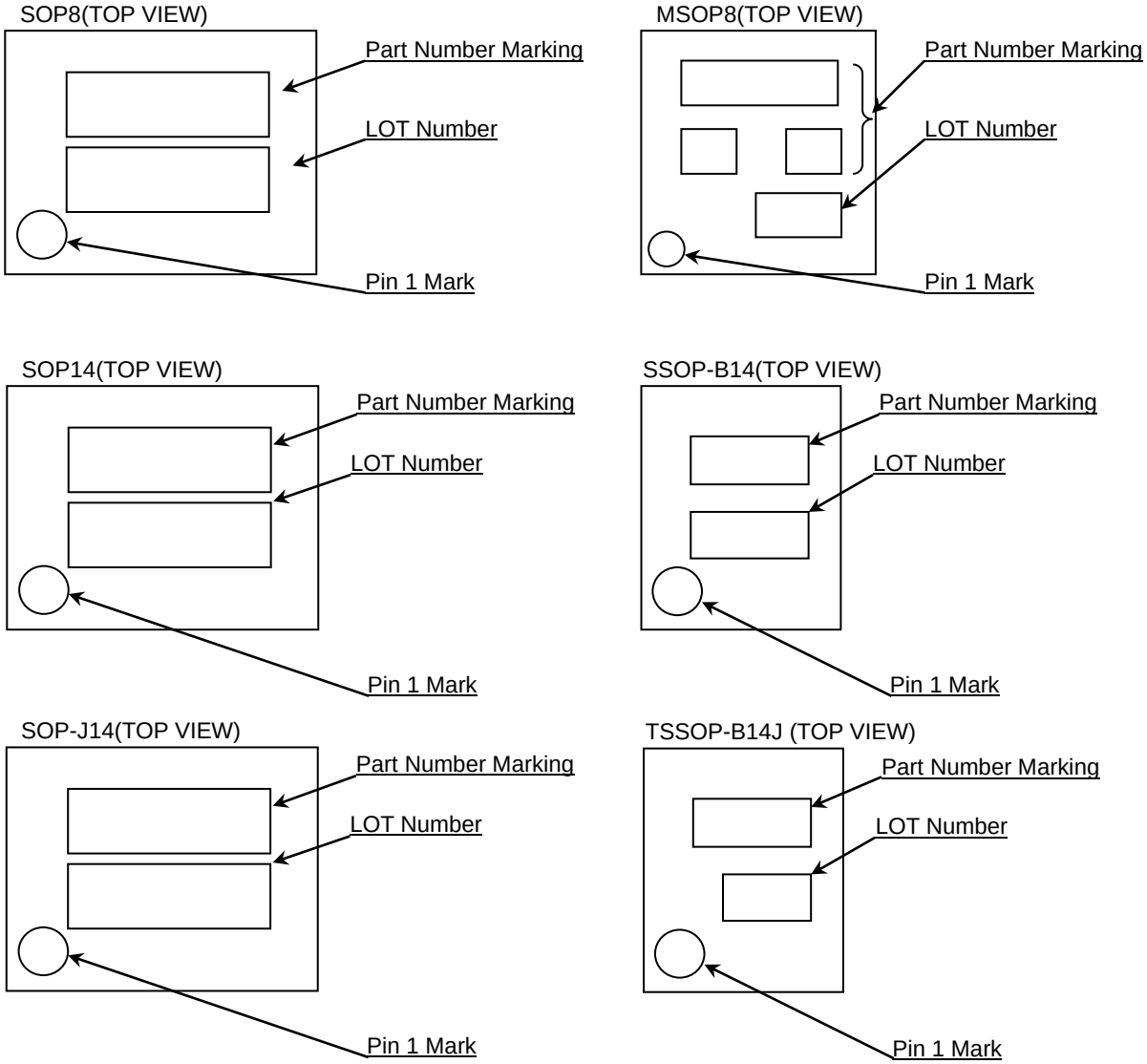
包装、フォーミング仕様
C:　車載向け(エンジンコントロールユニット、EPS、ABS など)
E2:　リール状エンボステーピング (SOP8/SOP14/SSOP-B8/SSOP-B14 /SOP-J14/TSSOP-B14J)
TR:　リール状エンボステーピング (MSOP8)

ラインアップ

動作温度範囲	動作電源電圧	回路数	パッケージ		発注可能形名
-40°C～+125°C	3V～36V	2 回路	SOP8	Reel of 2500	BA82904YF-CE2
			MSOP8	Reel of 3000	BA82904YFVM-CTR
		4 回路	SOP14	Reel of 2500	BA82902YF-CE2
			SSOP-B14	Reel of 2500	BA82902YFV-CE2
			SOP-J14	Reel of 2500	BA82902YFJ-CE2
			TSSOP-B14J	Reel of 2500	BA82902YFVJ-CE2

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

標印図

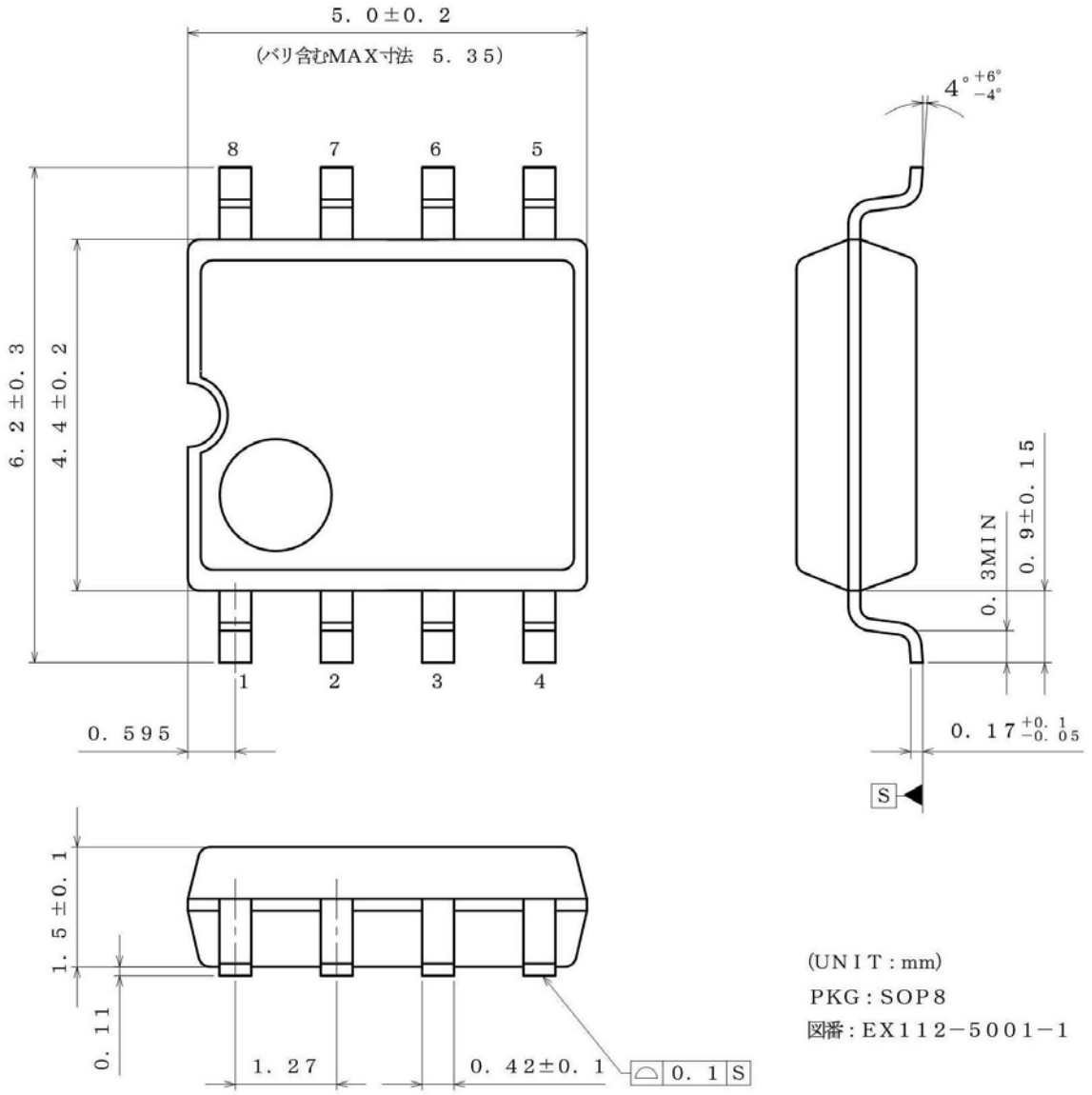


品番		パッケージ	標印
BA82904Y	F-C	SOP8	82904
	FVM-C	MSOP8	82904
BA82902Y	F-C	SOP14	BA82902YF
	FV-C	SSOP-B14	802Y
	FJ-C	SOP-J14	82902YFJ
	FVJ-C	TSSOP-B14J	802YJ

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

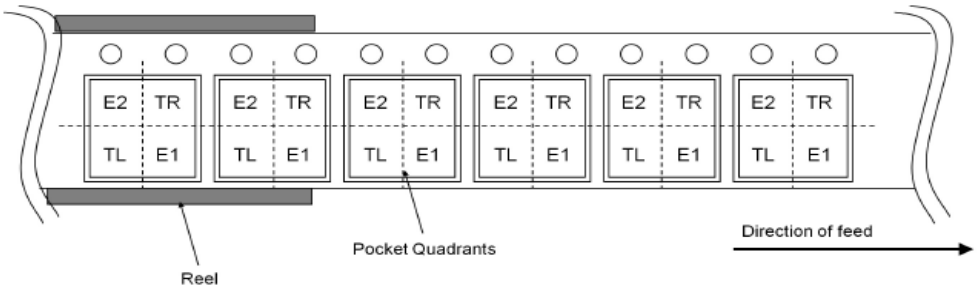
外形寸法図と包装・フォーミング仕様

Package Name	SOP8



＜包装仕様＞

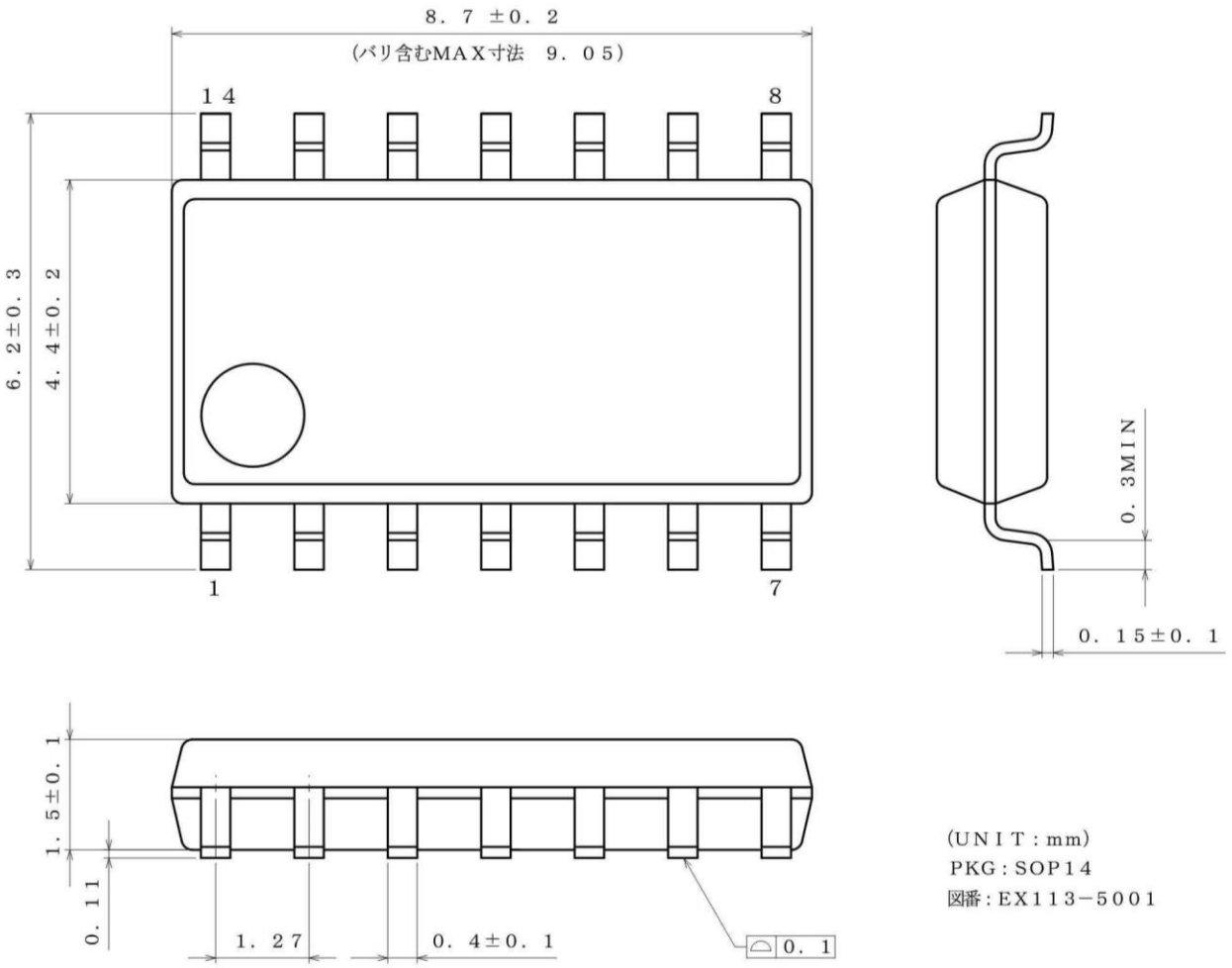
包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 （リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに製品の1番ピンが左上にくる方向）



© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

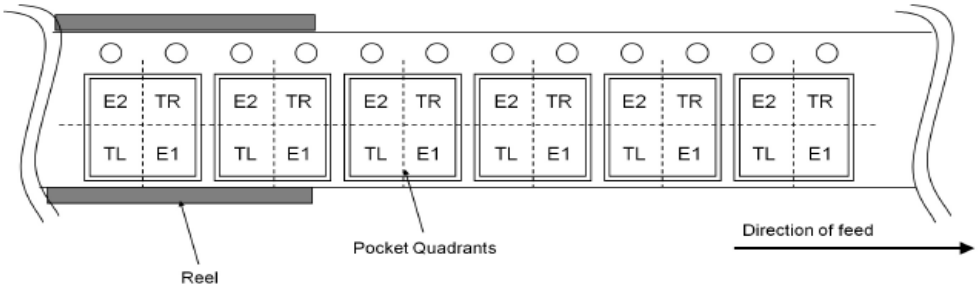
外形寸法図と包装・フォーミング仕様　–　続き

Package Name	SOP14



＜包装仕様＞

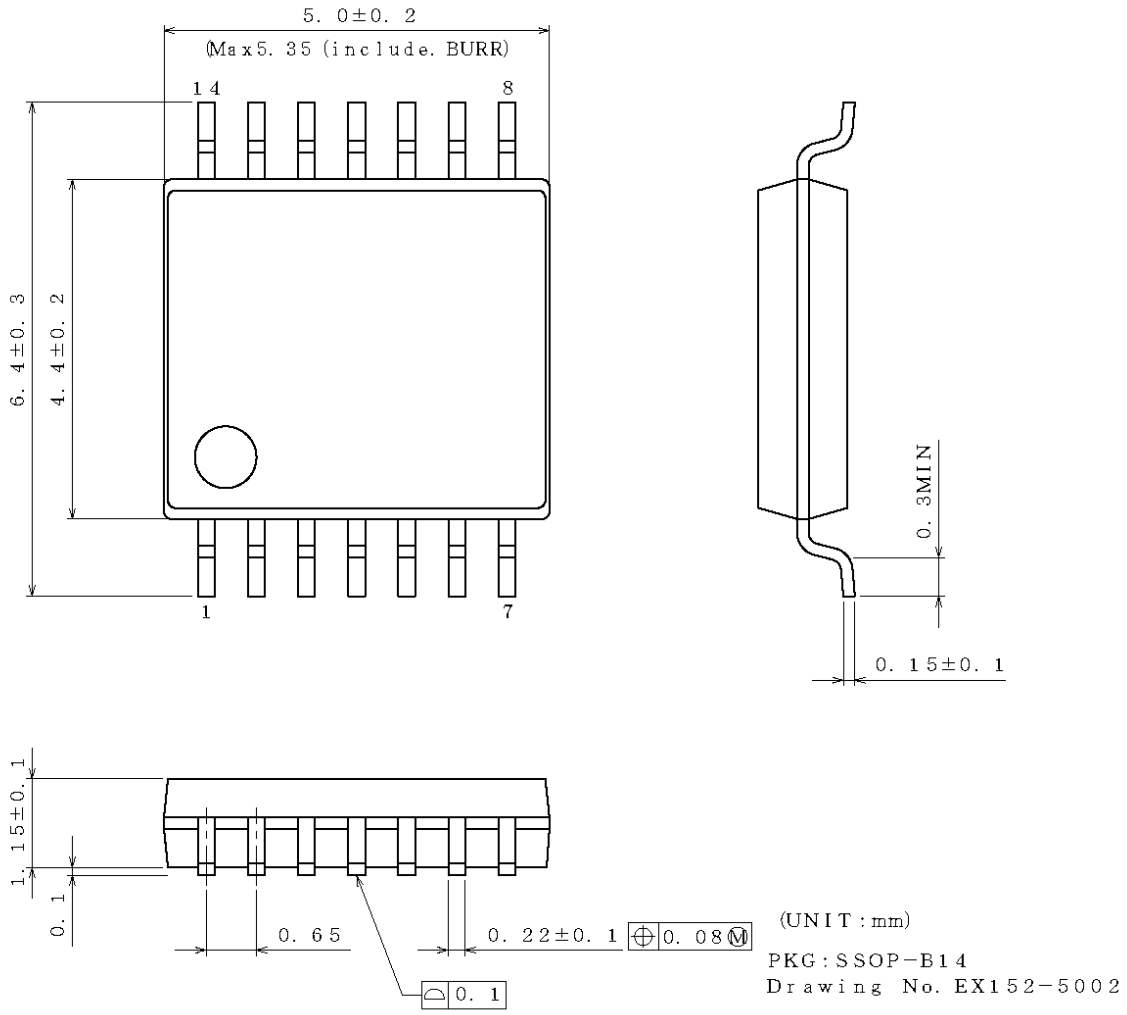
包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに製品の1番ピンが左上にくる方向)



© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

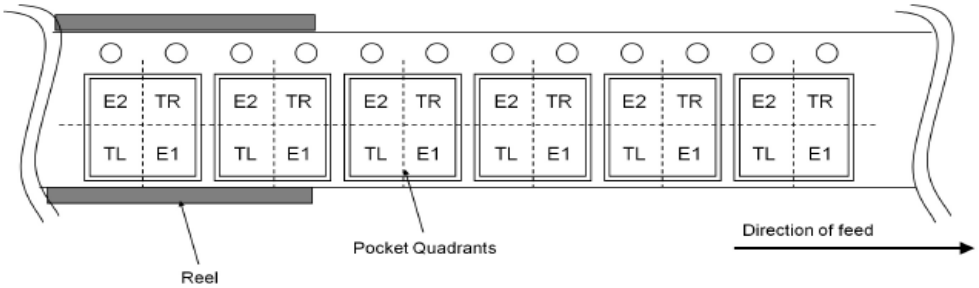
外形寸法図と包装・フォーミング仕様　–　続き

Package Name	SSOP-B14



＜包装仕様＞

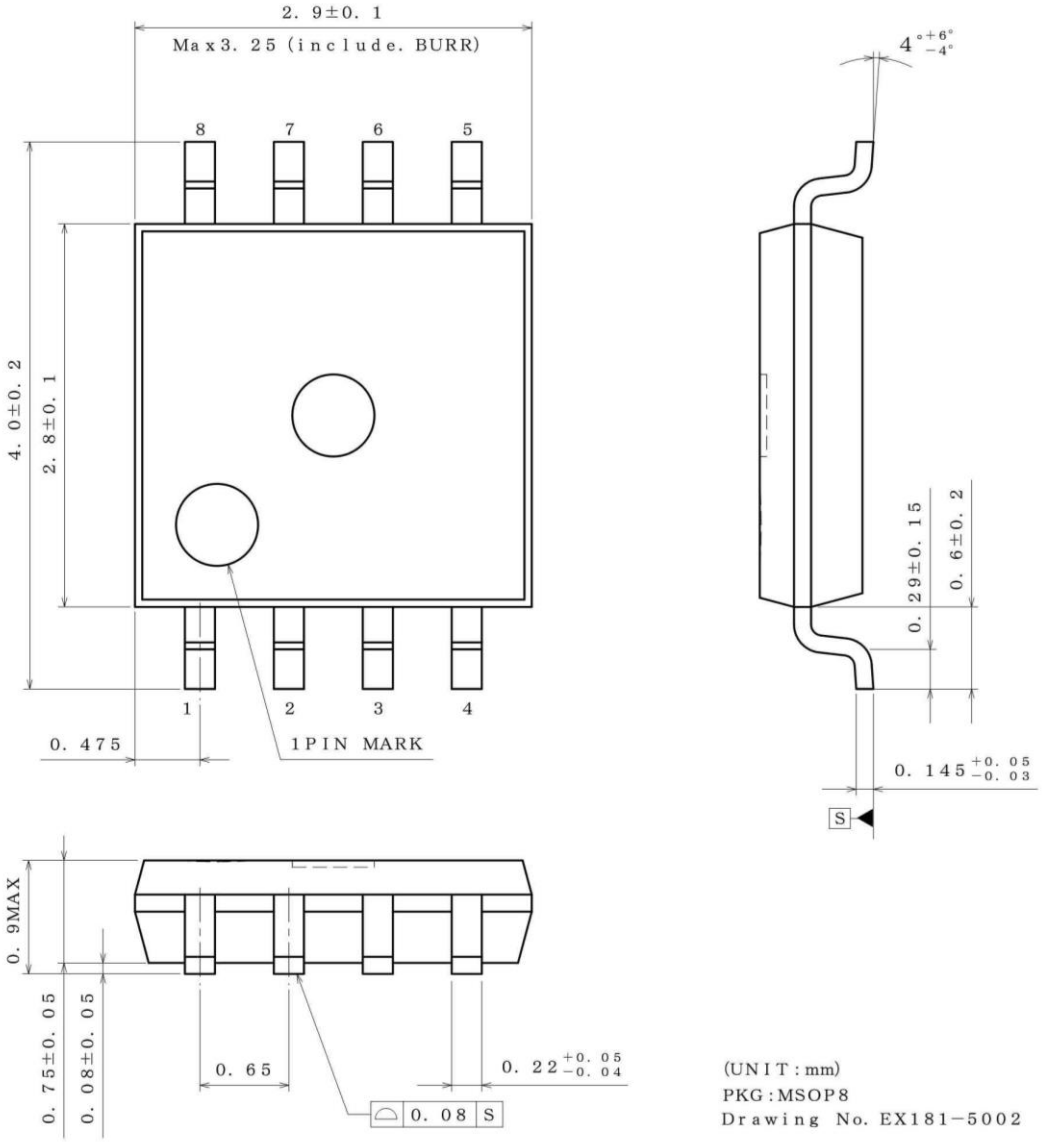
包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに製品の1番ピンが左上にくる方向)



© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

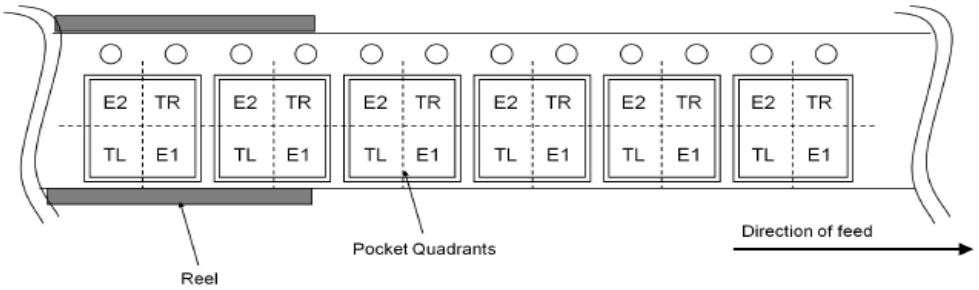
外形寸法図と包装・フォーミング仕様　–　続き

Package Name	MSOP8



＜包装仕様＞

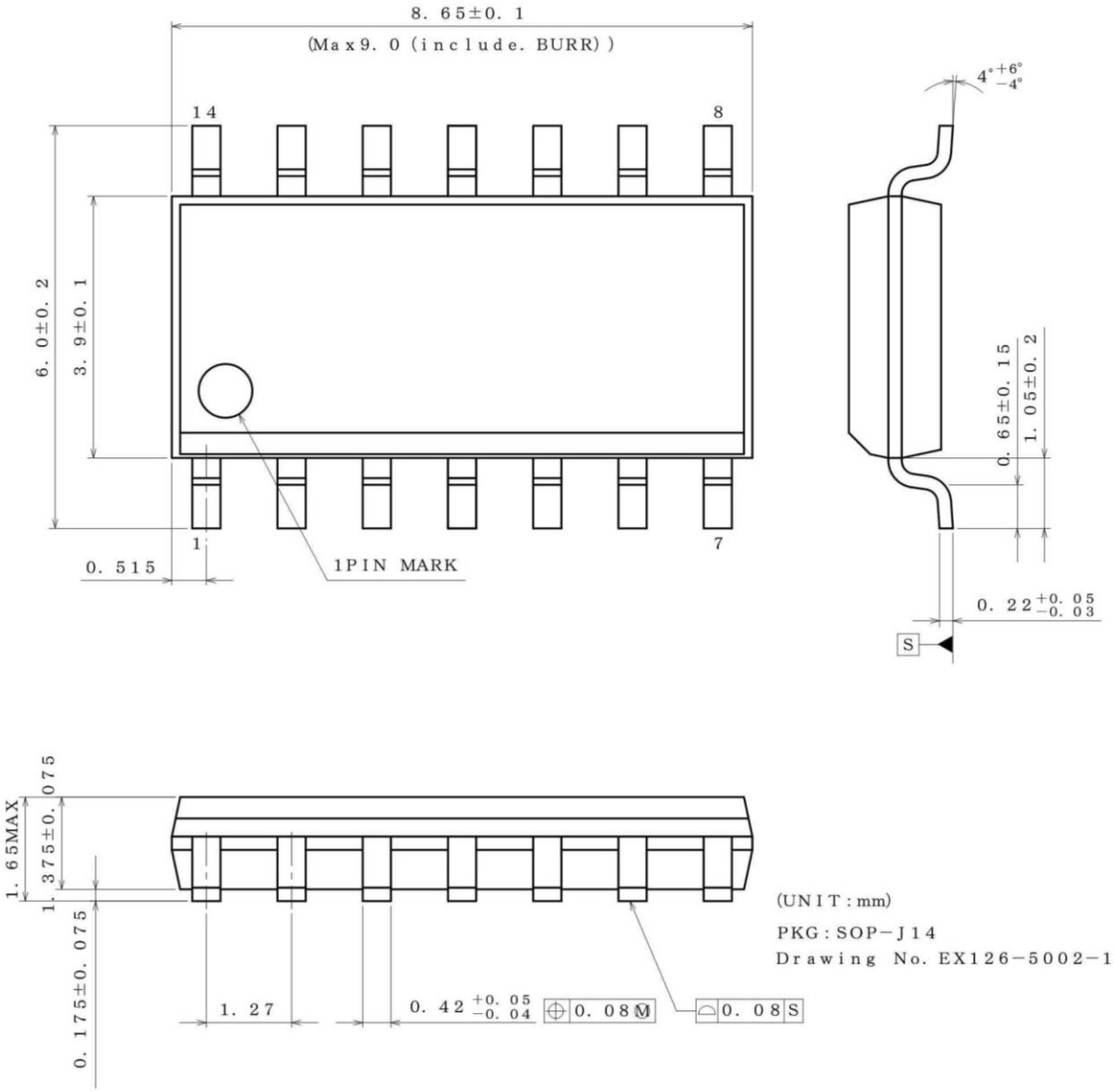
包装形態	エンボステーピング
包装数量	3000pcs
包装方向	TR （リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに製品の1番ピンが右上にくる方向）



© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

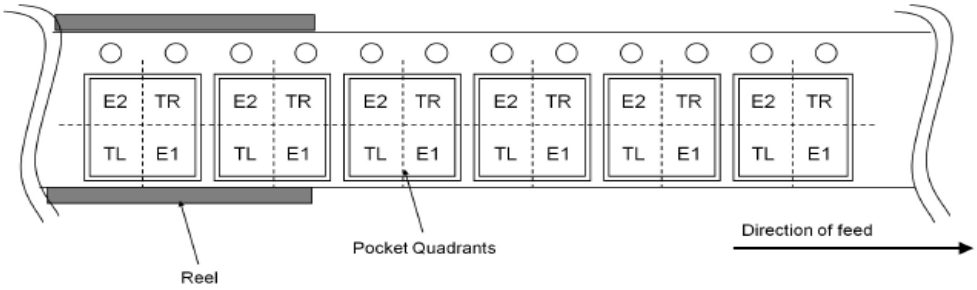
外形寸法図と包装・フォーミング仕様　–　続き

Package Name	SOP-J14



＜包装仕様＞

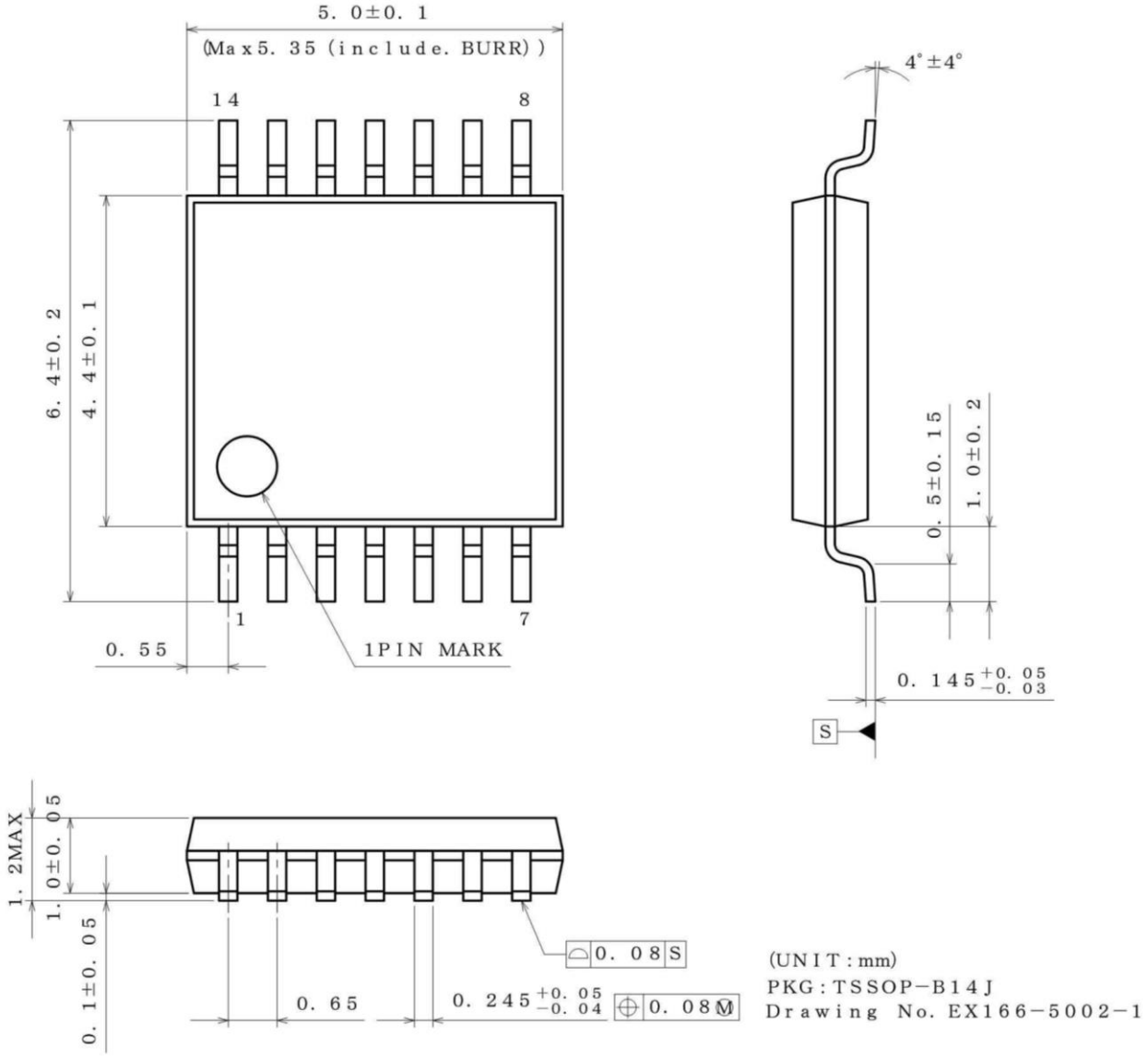
包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 （リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに製品の1番ピンが左上にくる方向）



© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

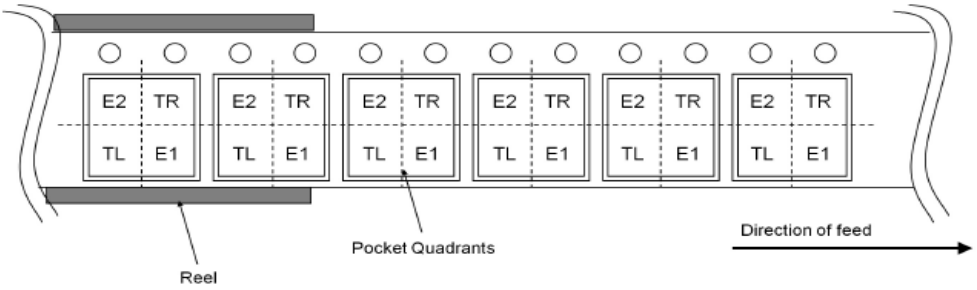
外形寸法図と包装・フォーミング仕様　–　続き

Package Name	TSSOP-B14J



＜包装仕様＞

包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 （リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに製品の1番ピンが左上にくる方向）



© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

改訂履歴

日付	Revision	改訂内容
2017.05.10	001	New Release
2017.06.01	002	誤記修正：P.3 *(Note 2)* 削除
2017.06.14	003	P.3 発注可能形名更新
2017.06.29	004	P.1 文言追加 P.23 アプリケーションヒント追加
2017.07.27	005	外形寸法図と包装・フォーミング仕様更新
2017.08.31	006	P.5-6 規格値変更
2018.02.20	007	ラインアップ更新 (BA82902YFJ-C, BA82902YFVJ-C)
2020.04.15	008	誤記修正：P.5-6 単位変更
2022.09.22	009	英文変更に伴う Revision Up

© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険もしくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器(Note 1)、航空宇宙機器、原子力制御装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASSⅢ	CLASSⅢ	CLASSⅡb	Ⅲ類
CLASSⅣ		CLASSⅢ	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
   ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
   ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。

3. 本製品は、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておりません。したがいまして、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
   ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
   ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
   ③潮風、Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_2 等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
   ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
   ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合
   ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用
   ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用される場合は除く。ただし、残渣については十分に確認をお願いします。)又は、はんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合
   ⑧結露するような場所でのご使用

4. 本製品は耐放射線設計はなされておりません。

5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。

6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。

7. 電力損失は周囲温度に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、最高接合部温度を超えていない範囲であることをご確認ください。

8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。

9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。

2. はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせて頂きます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。
   その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。

2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがいまして、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施のうえ、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。（人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等）

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
   ① 潮風、Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_2 等の腐食性ガスの多い場所での保管
   ② 推奨温度、湿度以外での保管
   ③ 直射日光や結露する場所での保管
   ④ 強い静電気が発生している場所での保管

2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認したうえでご使用頂くことを推奨します。

3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き（梱包箱に表示されている天面方向）で取り扱いください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。

4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行ったうえでご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに２次元バーコードが印字されていますが、２次元バーコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は、外国為替及び外国貿易法に定めるリスト規制貨物等に該当するおそれがありますので、輸出する場合には、ロームへお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。

2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等（ソフトウェア含む）との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。

3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ロームもしくは第三者が所有又は管理している知的財産権 その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。 ただし、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。

2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。

3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。

4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社もしくは第三者の商標又は登録商標です。

© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。

2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。

3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。

© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.